

SPring-8利用推進協議会 先端磁性材料研究会 第3回研究会  
「パターン媒体の先端技術開発とナノ磁気イメージングからのアプローチ」

# 硬X線フーリエ変換ホログラフィー によるパターン媒体のイメージング

鈴木 基寛 (JASRI/SPring-8)

# 共同研究者

近藤裕治 (秋田県産業技術総合研究センター)

角田匡清, 磯上慎二 (東北大院工)

高橋信吾, 石尾俊二 (秋田大)

中村哲也 (JASRI/SPring-8)

淡路直樹, 野村健二 (富士通(株))

**平成20年度科研費 (基盤研究 (C) )**

「放射光のコヒーレンスと偏光特性を活用した硬X線磁気ホログラフィー法の開発」

**財団法人 村田学術振興財団 研究助成**

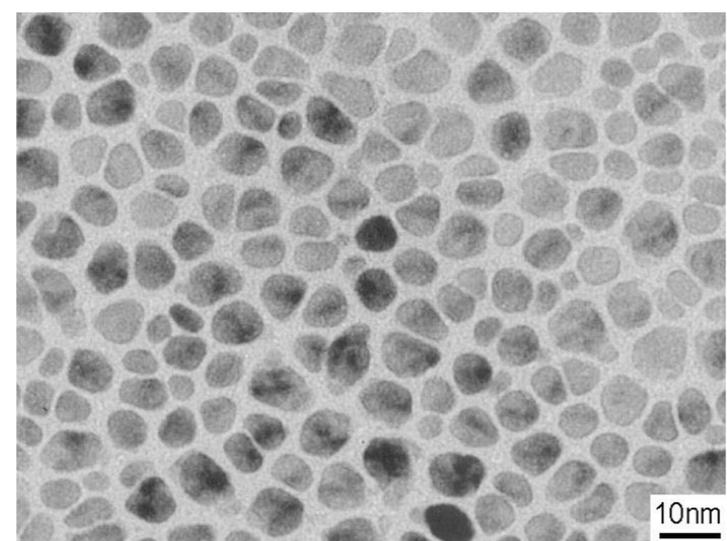
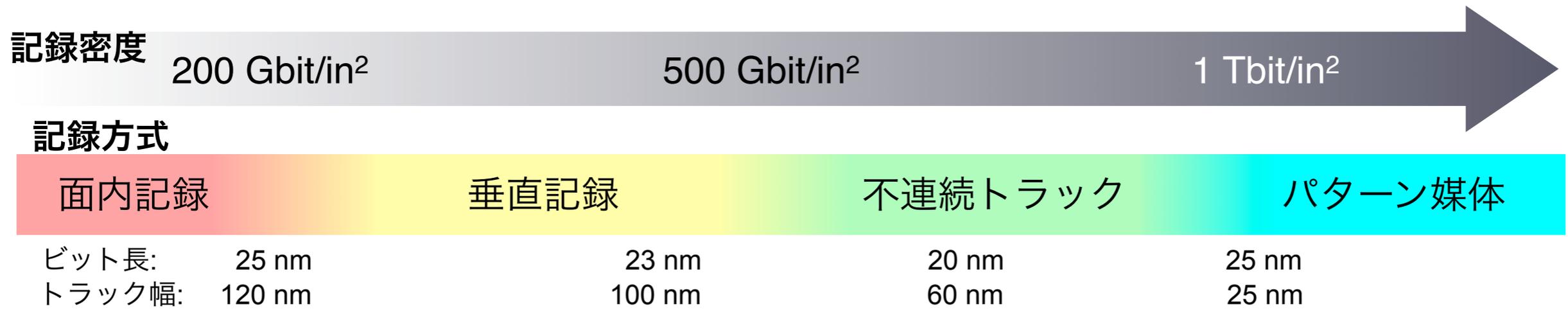
「硬X線磁気ホログラフィーイメージングによるナノ磁区構造の可視化」

# 講演内容

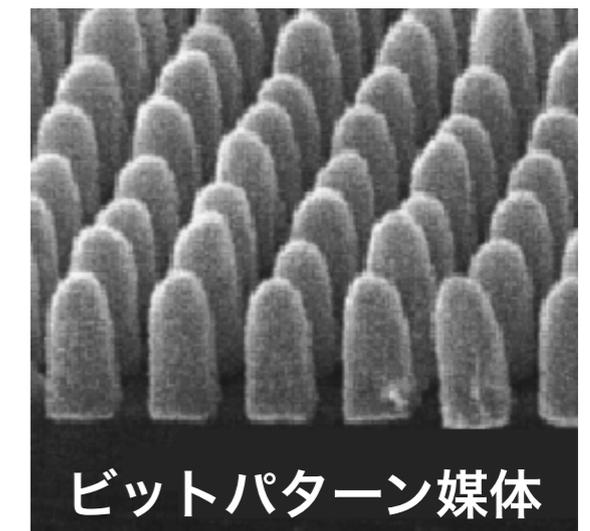
1. フーリエ変換ホログラフィー法とは
2. 硬X線ホログラフィー: 特色・何が難しいか
3. 電荷散乱ホログラフィー法の開発
4. 磁気ホログラフィー法 開発の現状
5. 今後の展開—XFELによる磁気デバイス解析に向けて

\*XFEL: X線自由電子レーザー (X-ray Free Electron Laser)

# 背景: 磁気記録媒体の高密度化



グラニューラー媒体



ビットパターン媒体

磁気記録媒体は  
連続膜 → ナノ構造へ

粒境界によるノイズの問題

$$1 \text{ Tbit/in}^2 = 25 \times 25 \text{ nm/bit} = 10^6 \text{ 原子/bit}$$

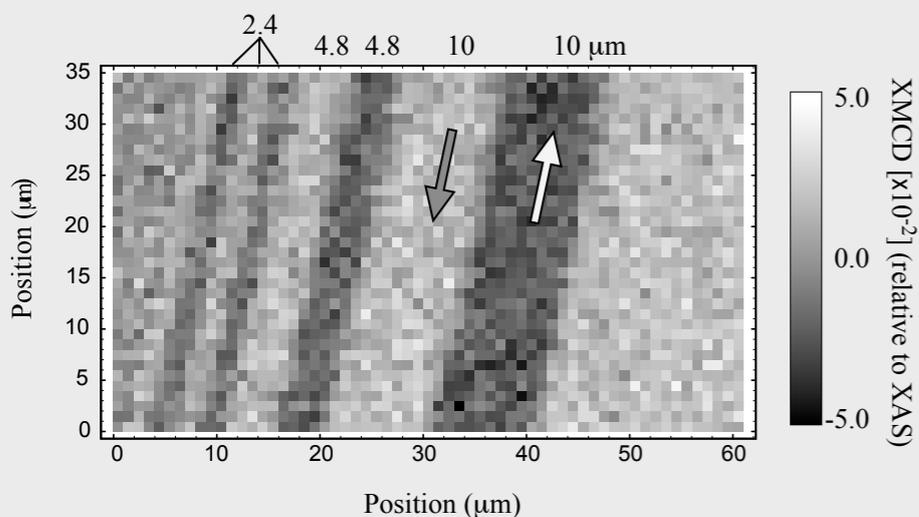
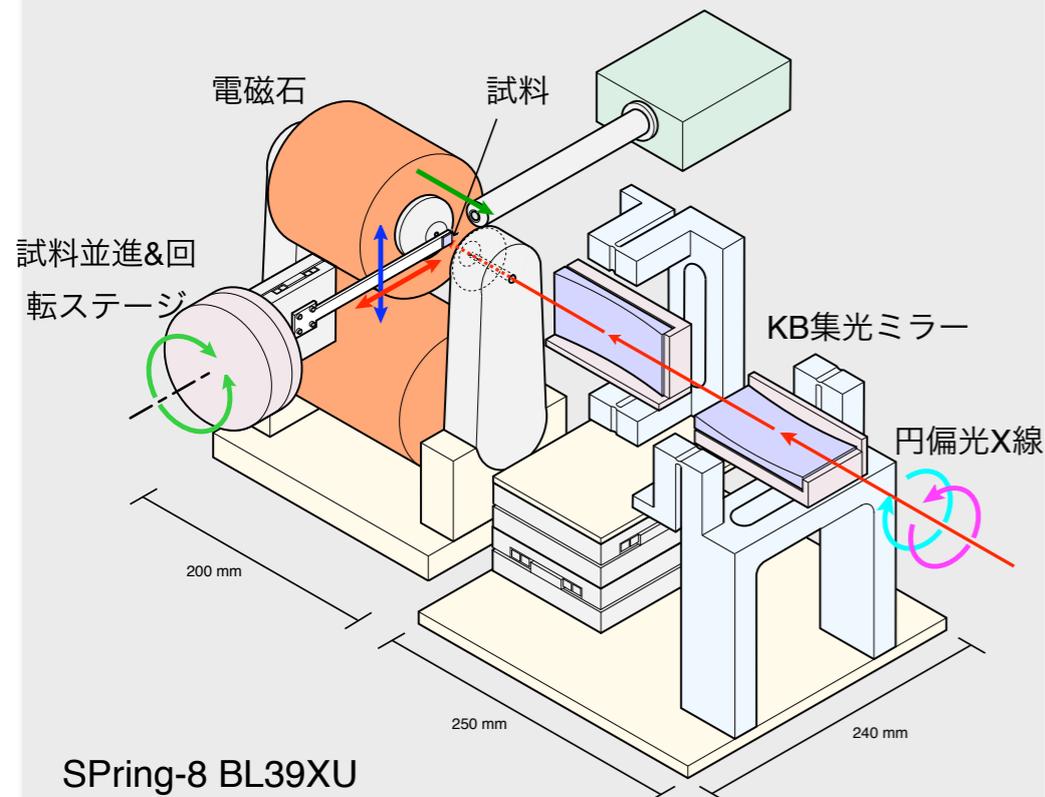
パターンニングによるダメージ?

**ナノ磁性 = モルフォロジーと磁性**

年表は東北大 角田氏から提供

# 従来のX線顕微鏡は？

## 硬X線走査型MCD顕微鏡



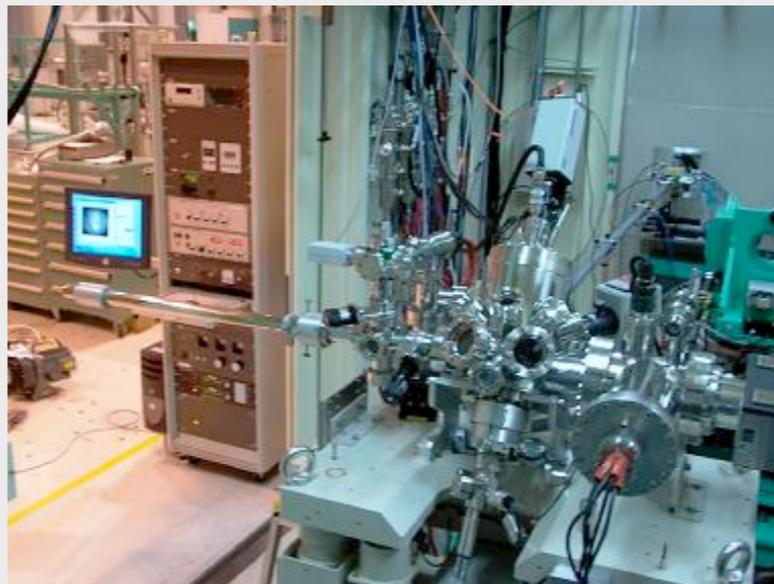
Takagaki, IPAP Conf. Series 7, 267 (2006).

× 実用空間分解能:  $\sim 1 \mu\text{m}$

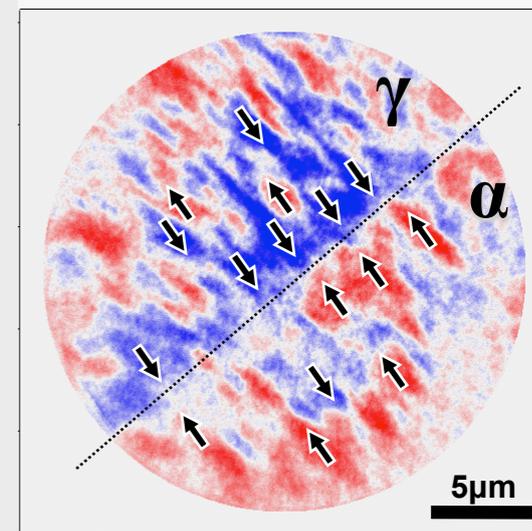
◎ 検出深さ:  $\sim$ 数  $\mu\text{m}$

◎ 磁場中測定が可能

## 光電子顕微鏡 (PEEM)



PEEM SPECTOR (ELMITEC)



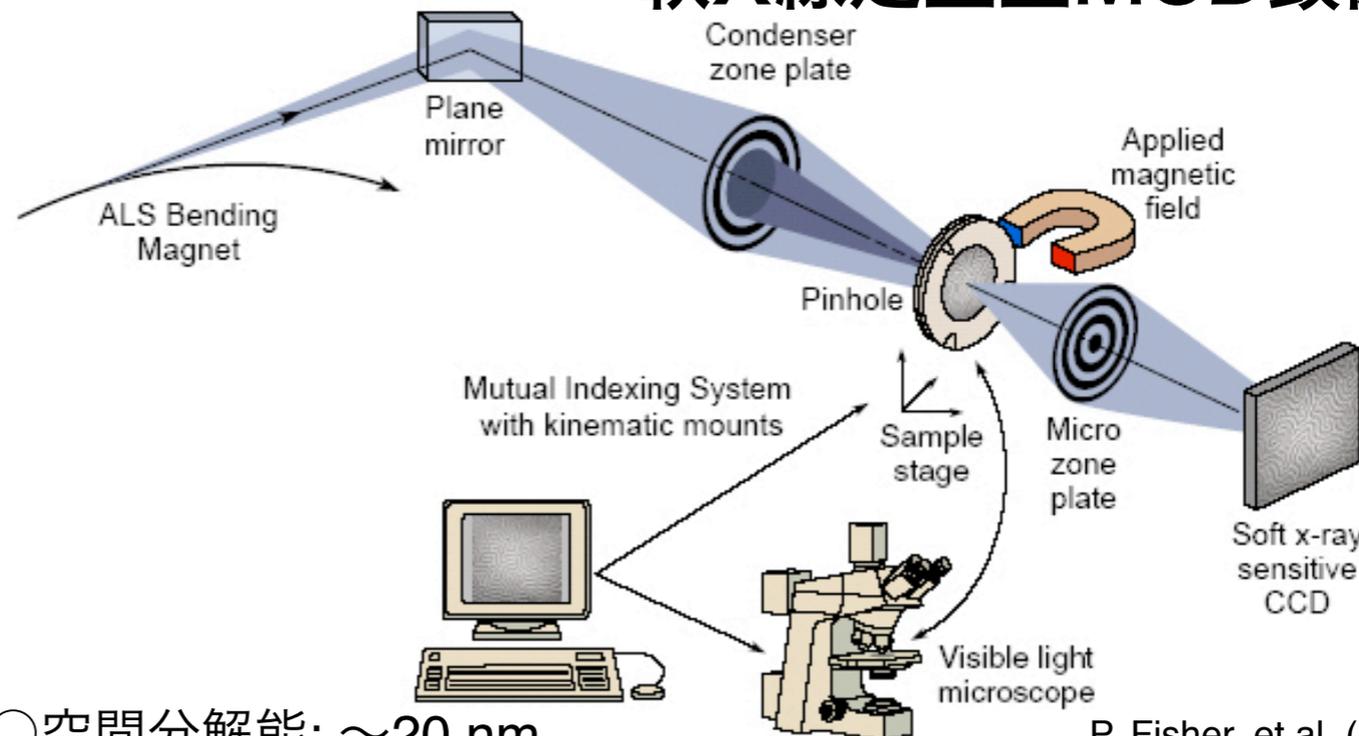
Kotsugi, APEX 3, 013001 (2010).

○ 空間分解能:  $\sim 20 \text{ nm}$

△ 検出深さ: 20 $\sim$ 200 nm

× 磁場中測定は不可

## 軟X線走査型MCD顕微鏡

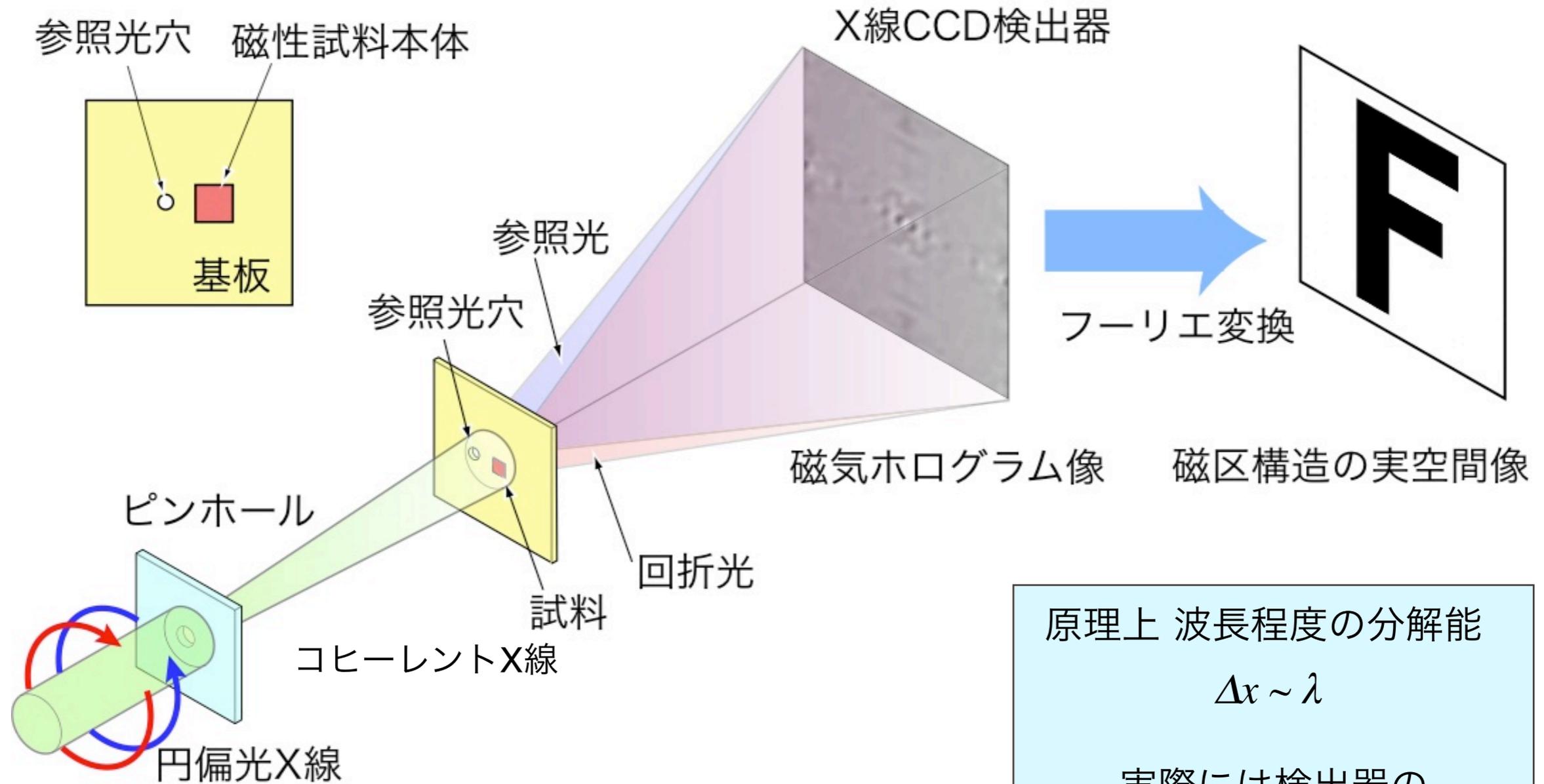


○ 空間分解能:  $\sim 20 \text{ nm}$

△ 検出深さ:  $\sim 100 \text{ nm}$  ◎ 磁場中測定が可能

P. Fisher, et al. (ALS Web)

# フーリエ変換ホログラフィー法



- 試料回折光と参照光との干渉によるホログラム
- 左右円偏光による差分像 → 磁気イメージ

原理上 波長程度の分解能

$$\Delta x \sim \lambda$$

実際には検出器の  
サイズと距離で決まる

$$\Delta x \sim \lambda z / a < 10 \text{ nm}$$

# 様々な波長域でホログラフィーは可能？

	波長 (nm)	浸透深さ	可干渉距離
可視光	~ 500	10 nm	~ mm*
UV, EUV	~ 50	10 nm	~ mm*
軟X線	~ 1	100 nm	~ 100 $\mu\text{m}$
硬X線	~ 0.1	10 $\mu\text{m}$	~ 10 $\mu\text{m}$
ガンマ線 (?)	< 0.01	> 1 mm	< 1 $\mu\text{m}$ (?)

\*レーザーが利用可能

- 空間分解能：原理的には波長に比例→短波長ほど有利
- 厚い試料の観察→短波長ほど有利
- 空間コヒーレンス(可干渉距離)→短波長ほど短い

第3世代放射光源で~10 $\mu\text{m}$  @ $\lambda=0.1$  nm

# X線ホログラフィーの特徴

- **高空間分解能** (原理的には波長に比例)
- **厚い試料の観察、バルク敏感性**
  - 軟X線 ... 100 nm
  - 硬X線 .... 10  $\mu\text{m}$
- **元素選択性**
  - 共鳴吸収端の利用
- **磁気イメージング**
  - 磁気円偏光二色性、共鳴吸収端の利用

# 硬X線ホログラフイーのメリット

- **バルク敏感性**

実デバイス試料の観察

表面保護層等の下に埋もれた磁性層

3次元観察 (CT)

- **試料環境の自由度**

超高真空環境が不要

強磁場、パルス磁場、書き込み用レーザー等の導入

- **XFEL (X線自由電子レーザー) への展開**

2010年度完成、2011年度から稼働予定

最初のビームラインは硬X線用



10 T 超伝導マグネット

# 硬X線と軟X線ホログラフieverの比較

\*[Co(0.4 nm)/Pt(1.1 nm)]<sub>40</sub> 多層膜 (厚さ 44 nm) に対する計算結果

元素吸収端	波長 (nm)	X線エネルギー (eV)	$\delta$	$\beta$	吸収率 (%)	位相シフト (°)
Co $L_3$	1.59	778	$2.1 \times 10^{-3}$	$1.8 \times 10^{-3}$	63	20.9
Pt $L_3$	0.107	11564	$1.5 \times 10^{-5}$	$2.7 \times 10^{-6}$	1.4	2.2

物質との相互作用：硬X線  $\ll$  軟X線

- ・ホログラフiever像のコントラスト低下
- ・十分な遮弊が得られない→参照光源？

# 硬X線で解決すべき点

## 参照光用の穴の作製

- ・ 小さい穴径→高分解能
- ・ 硬X線→重元素、厚さ必要
- ・ 細く深く掘らなければ！

直径 10 nm × 深さ 1 μm = 1:100 !



細く深く掘られた井戸

## 透過率

Au ( $Z = 79$ )

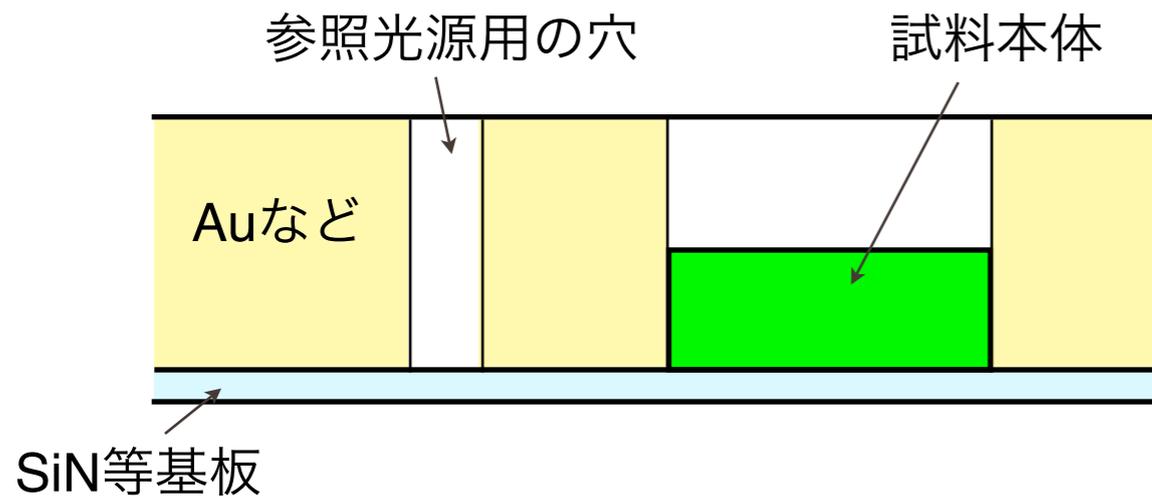
$T = 50\%$  ( $t = 1\mu\text{m}$ )@7 keV

$T = 80\%$  ( $t = 1\mu\text{m}$ )@10 keV

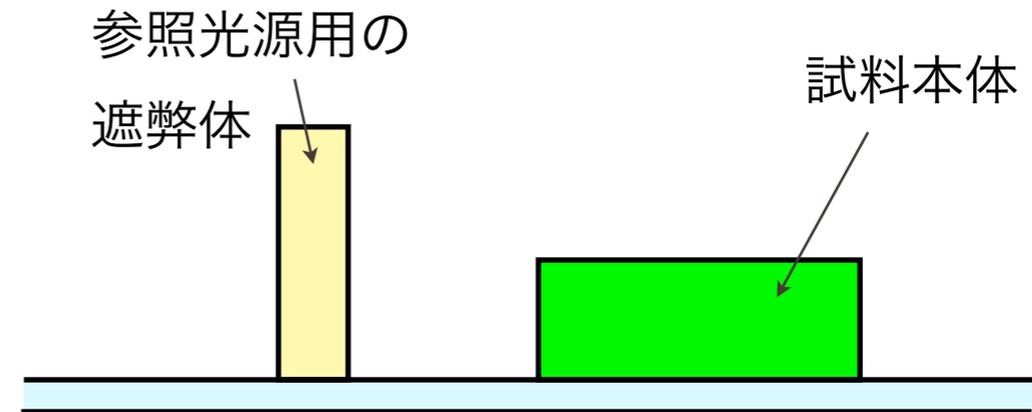
Auなど重金属膜でも完全な遮光は難しい

# 参照光源物体の検討

## a. 穴を参照光源とする



## b. 散乱体を参照光源とする

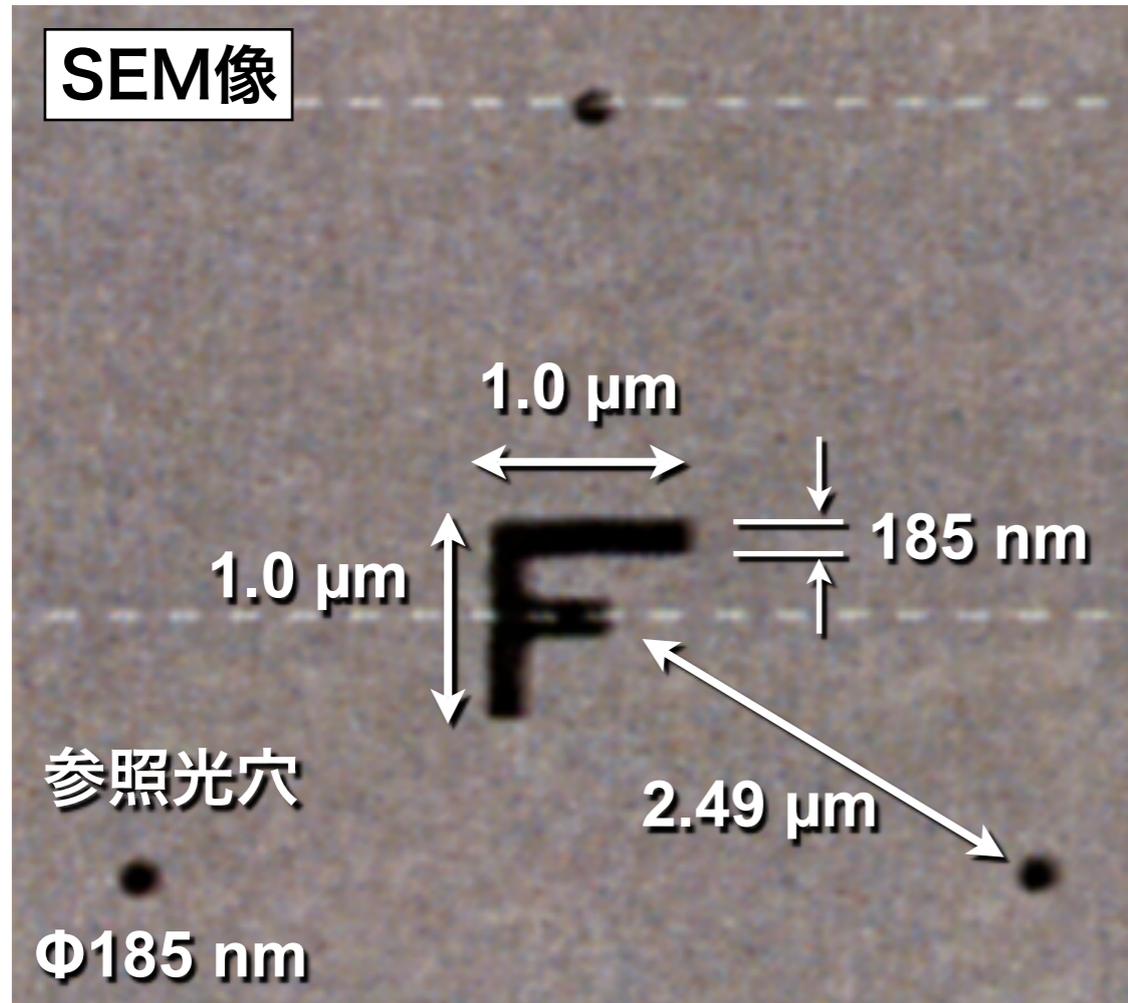


Q1. 穴 or 遮弊体? ... バビネの定理

Q2. 半透明 (位相物体) でも機能するか?

# “凹”試料 (穴を参照光源)

‘F’ パターン、参照光穴 3 個



膜: Ta (厚さ2.75  $\mu\text{m}$ )

基板: SiC メンブレン (厚さ240 nm)

パターン加工: FIB (収束イオンビーム)

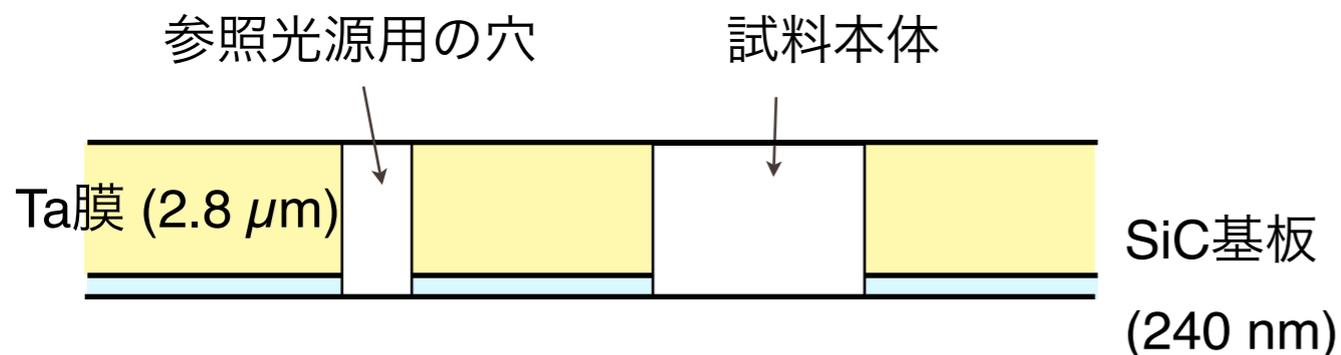
パターン幅: 185 nm

## Ta膜の透過率

Ta ( $Z = 73$ )

$T = 9\%$  ( $t = 2.75 \mu\text{m}$ )@5 keV

$T = 34\%$  ( $t = 2.75 \mu\text{m}$ )@10 keV



試料作製:

NTT-ATナノファブリケーション株式会社  
(フレネルゾーンプレートの実績)

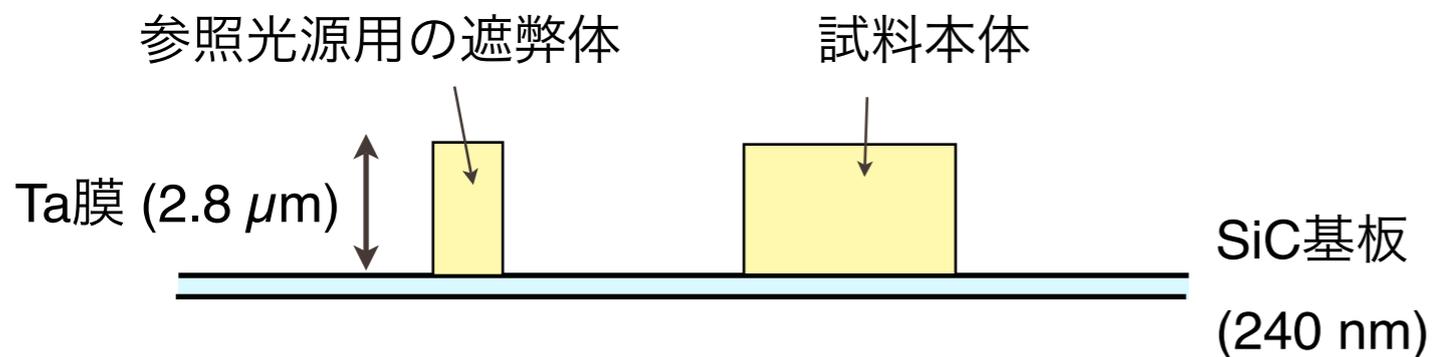
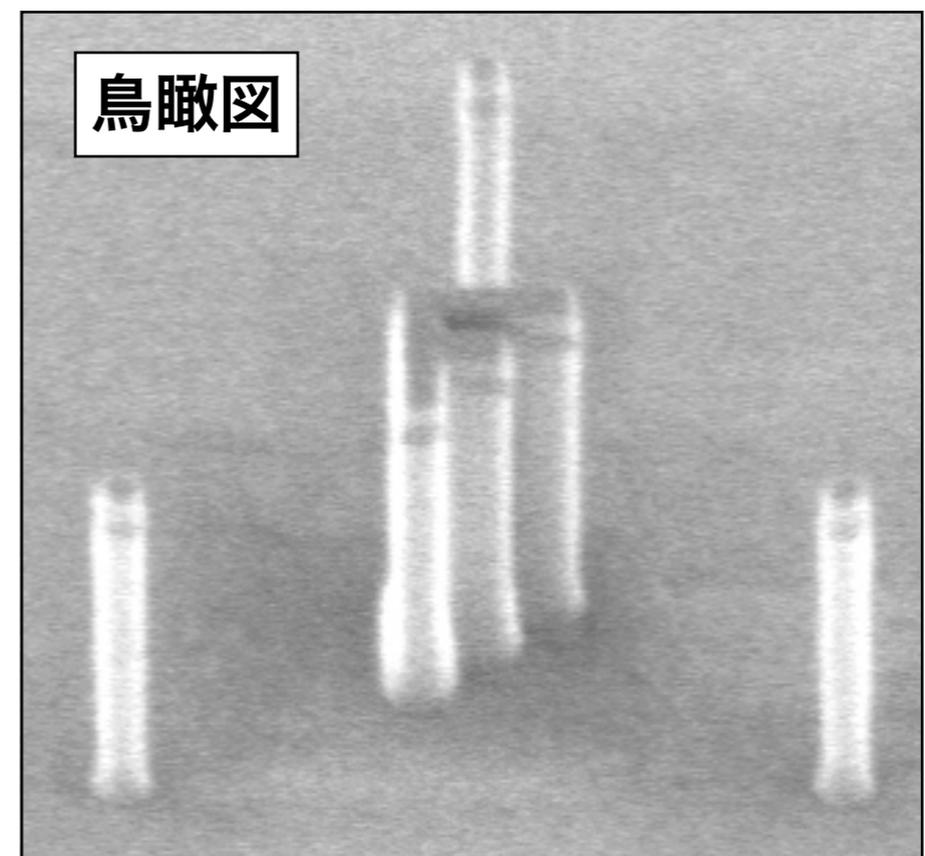
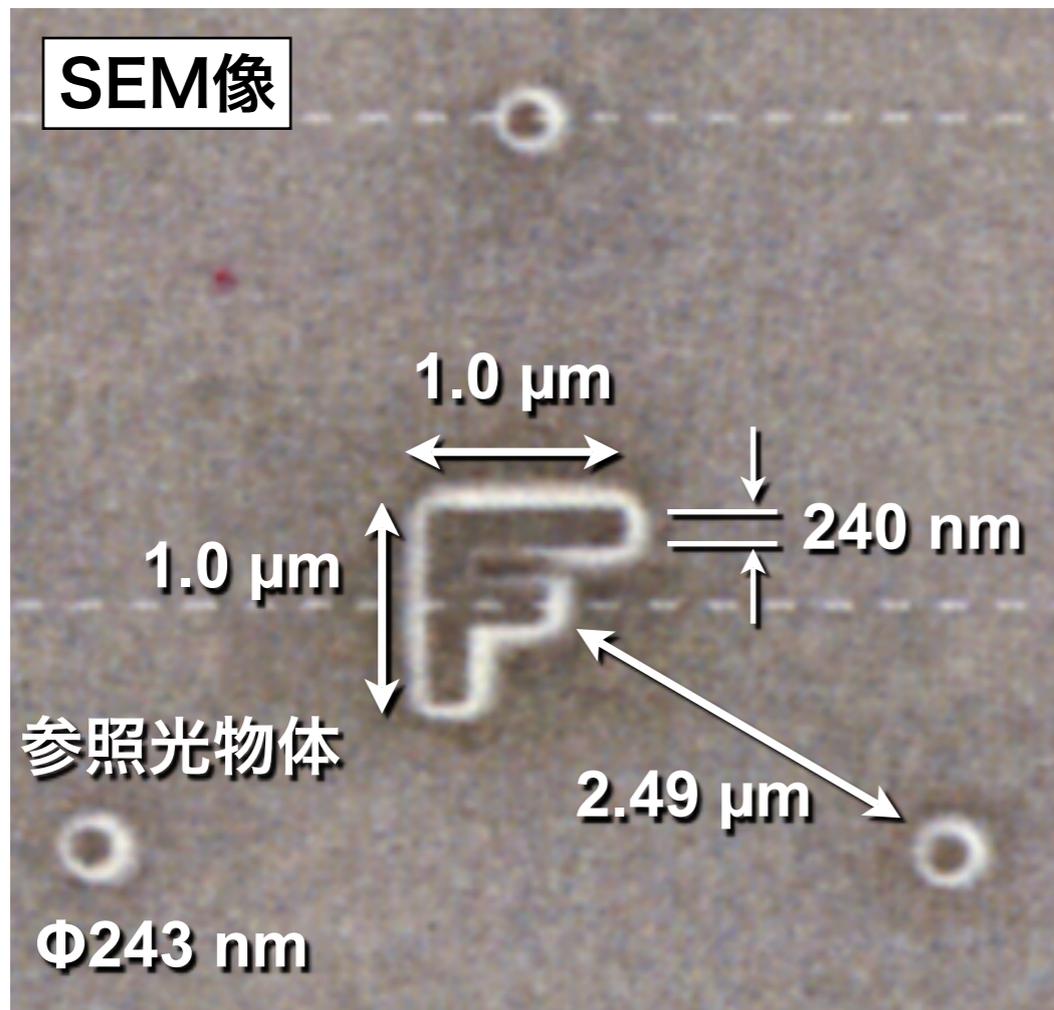
# “凸”試料 (散乱体を参照光源)

‘F’ パターン、参照光物体 3 個

膜: Ta (2.75  $\mu\text{m}$ )/SiC (240 nm)

パターン加工: FIBリソグラフィー

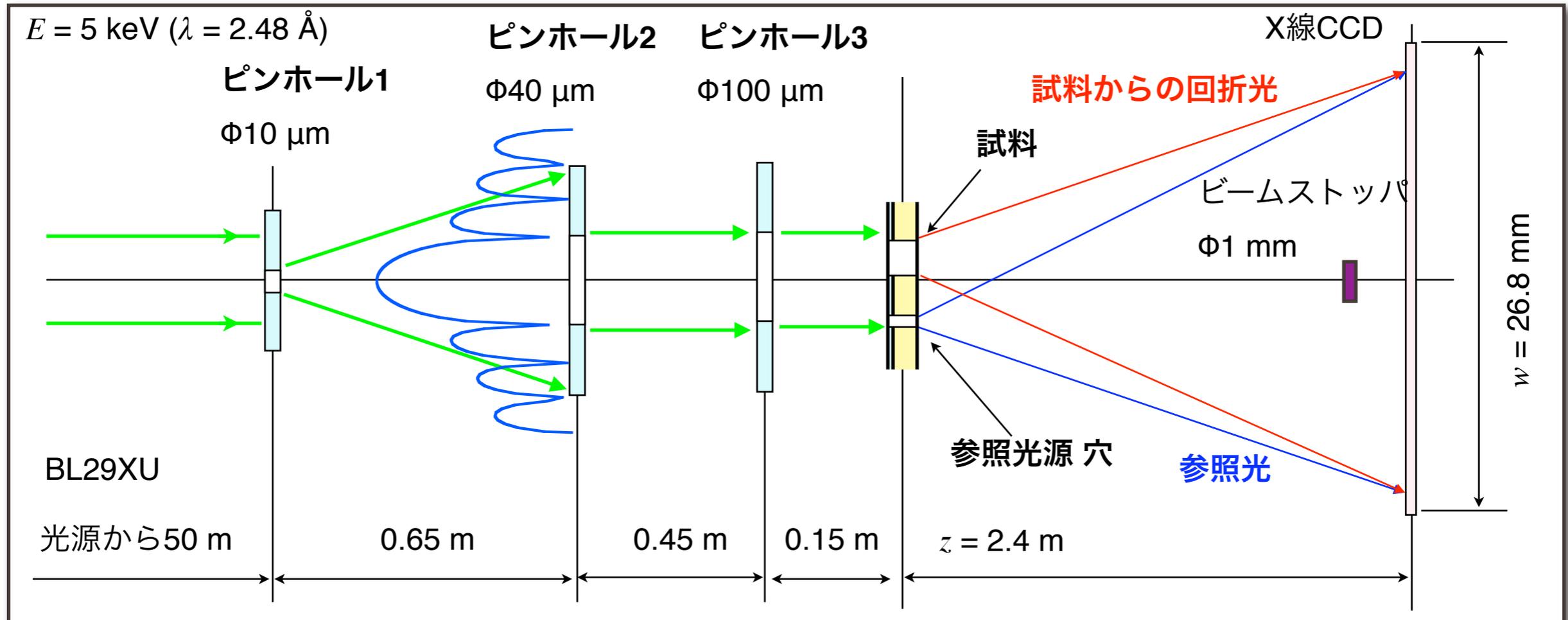
パターン幅: 240 nm



試料作製:

NTT-ATナノファブリケーション株式会社

# 実験配置



この配置での理論値

## 1. 空間分解能

$$\Delta x \geq \frac{\lambda z}{w/2} = 46 \text{ nm}$$

## 2. 観察可能な視野

$$x_{\text{max}} = \frac{\lambda z}{2p_x} = 15 \mu\text{m} \text{ 四方}$$

X線CCD:

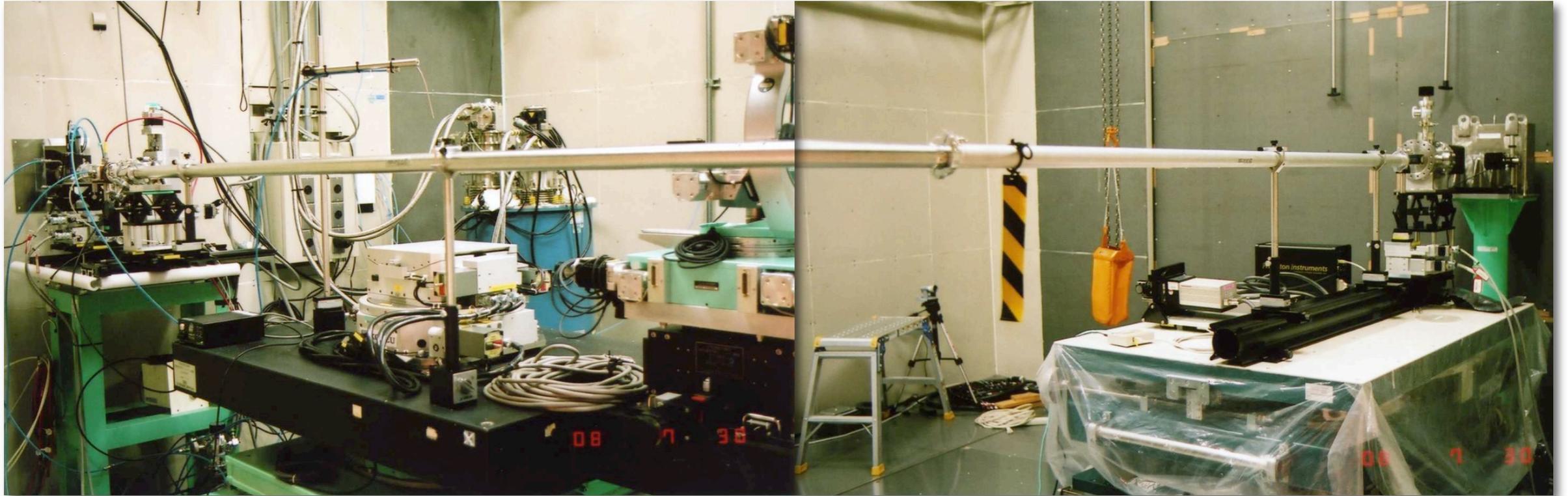
Princeton Instruments  
PI-LCX-1300

素子面積: 26.8 x 26.0 mm

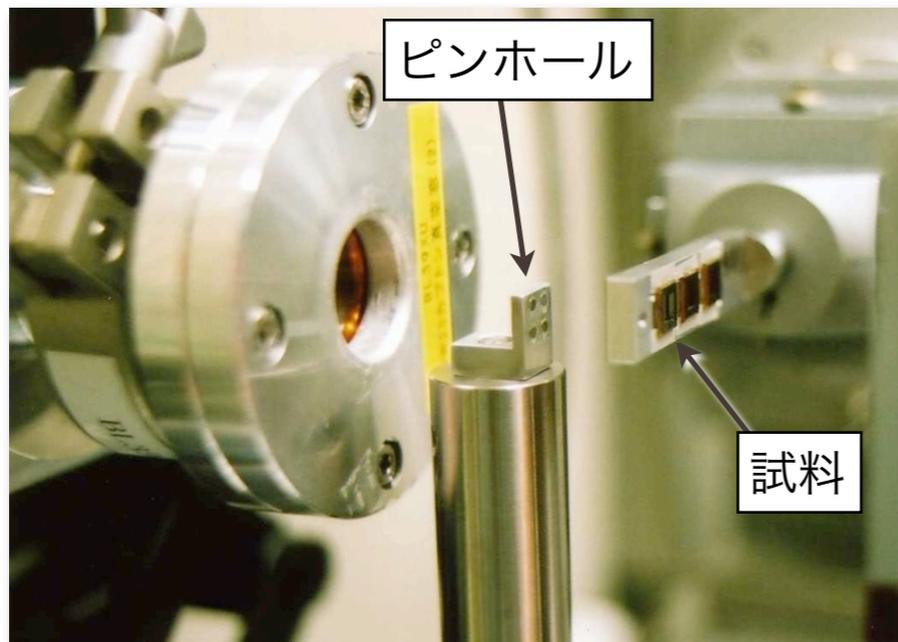
1340 x 1300ピクセル

ピクセルサイズ:  $p_x = 20 \mu\text{m}$

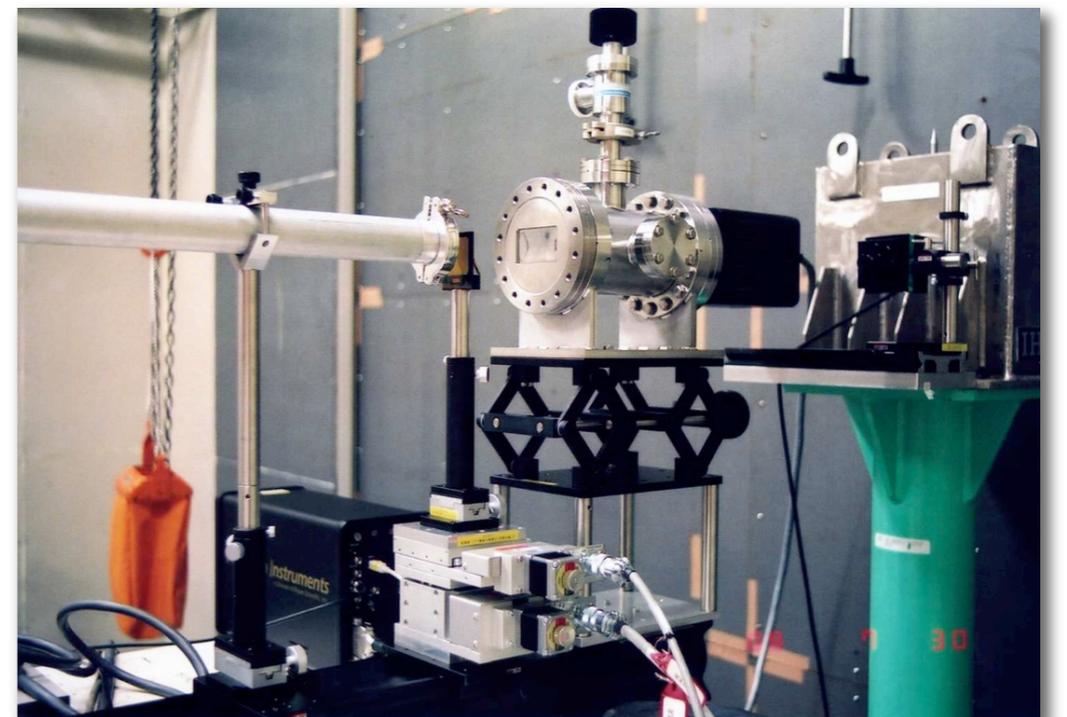
# 実験の様子



SPring-8 BL39XUビームライン

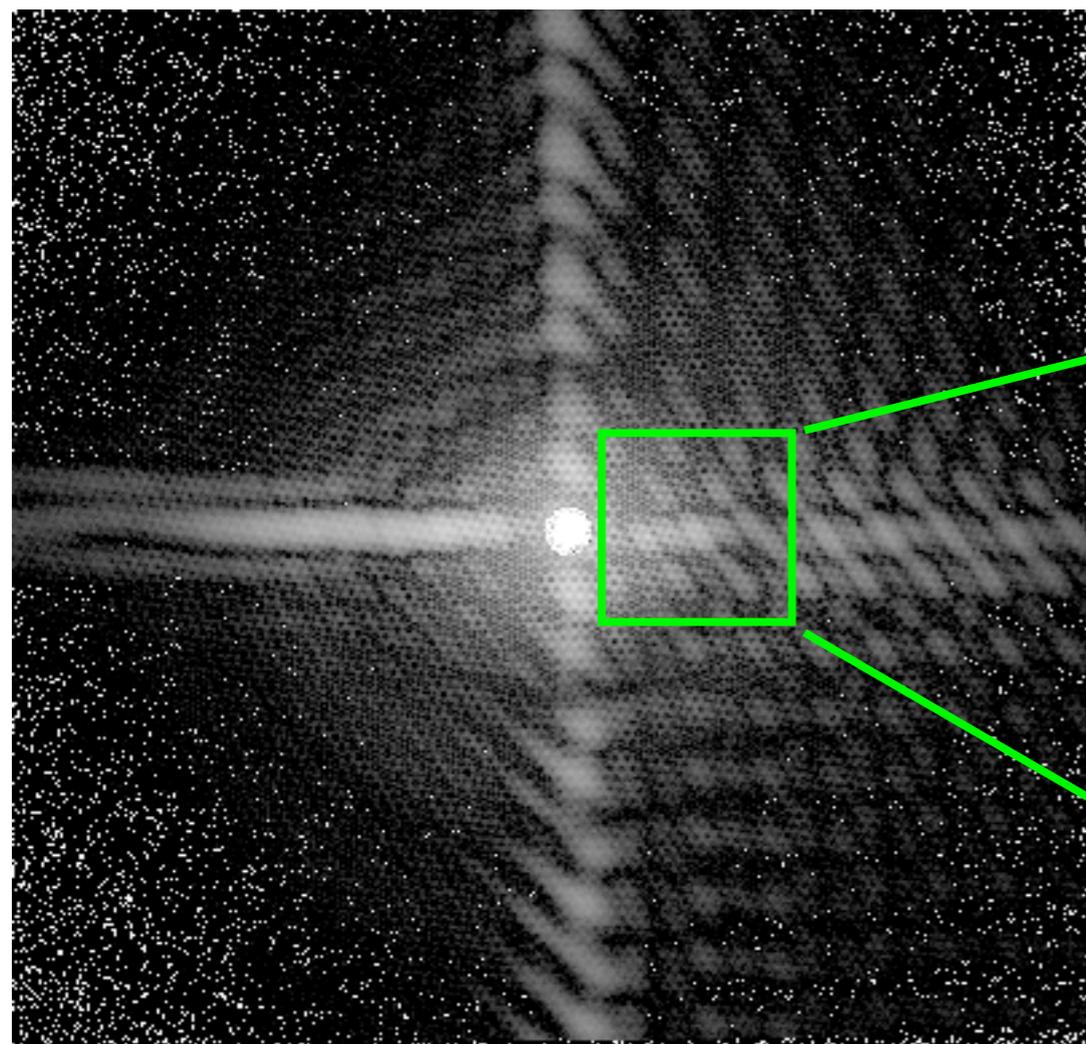


試料まわり



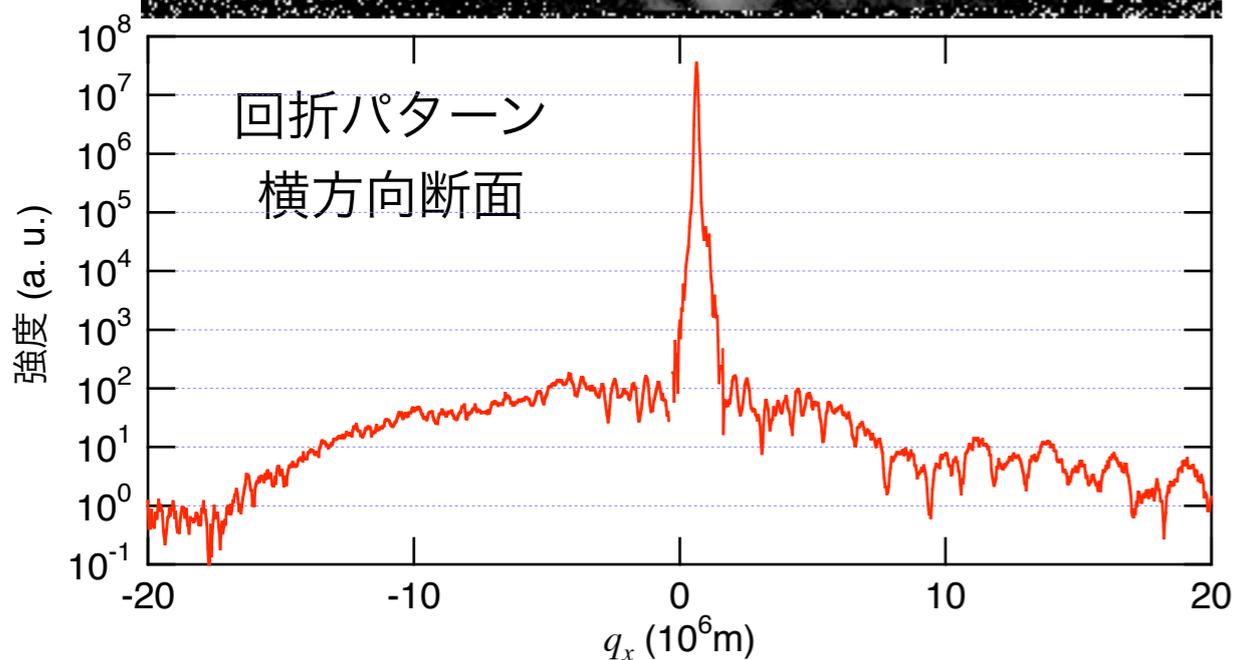
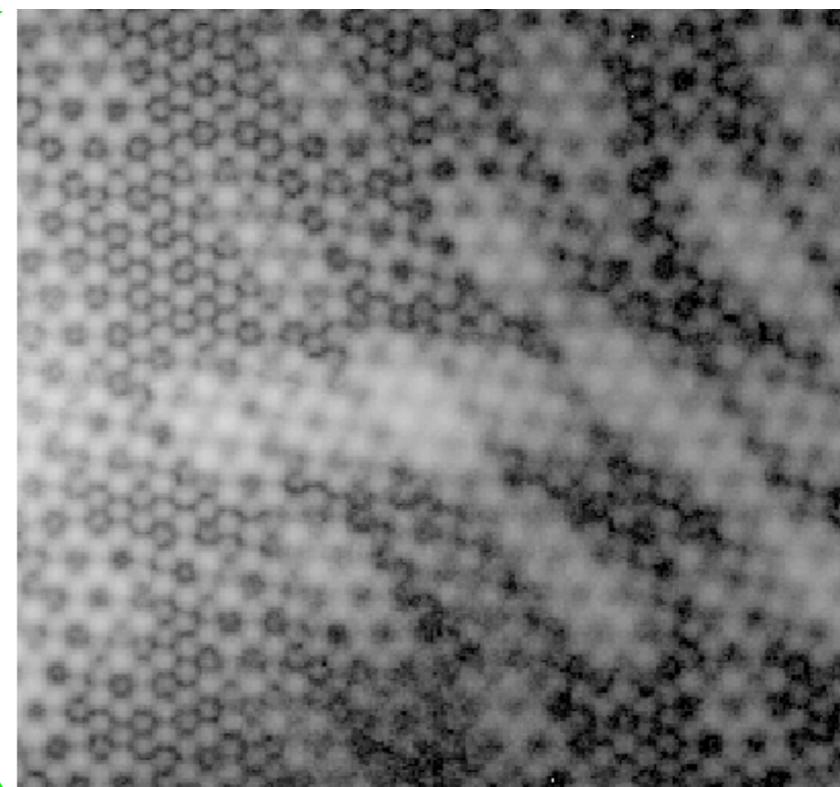
X線CCDとビームストッパ

# ホログラフィーパターン (“穴”試料)



回折パターン  
濃淡はログスケール  
 $E = 5 \text{ keV } (\lambda = 2.48 \text{ \AA})$

蜂の巣状の干渉縞



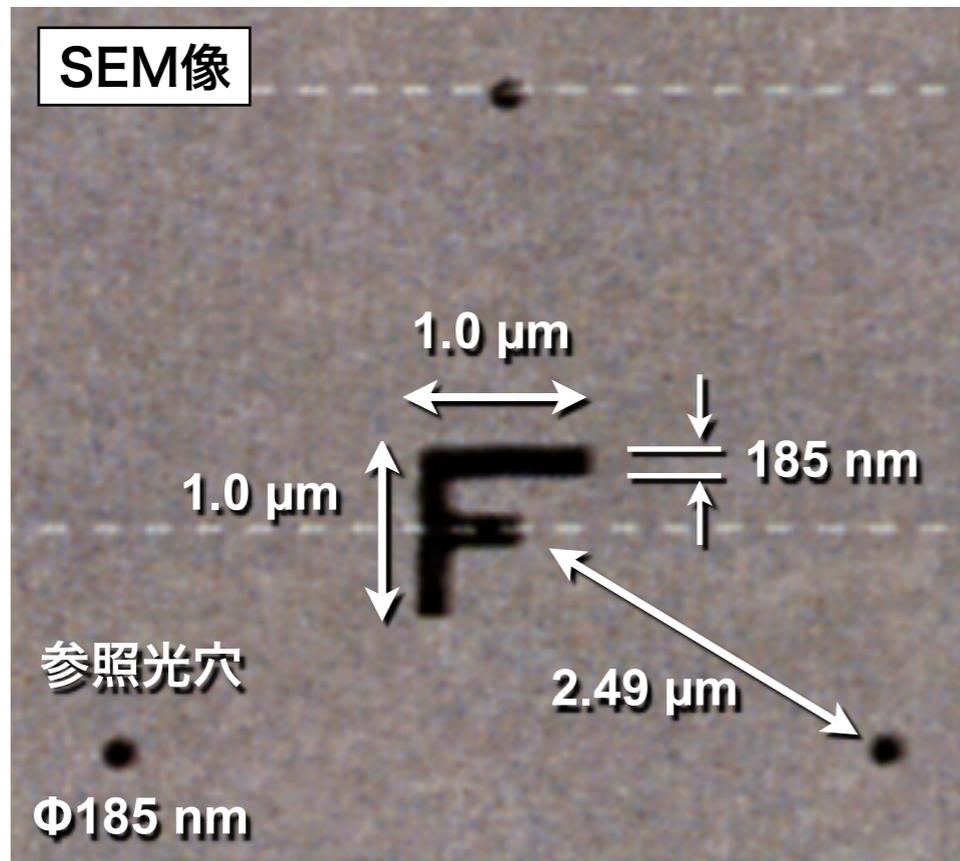
蜂の巣状の干渉縞 → 試料-参照光穴の干渉

多段階露出 → ダイナミックレンジ8桁

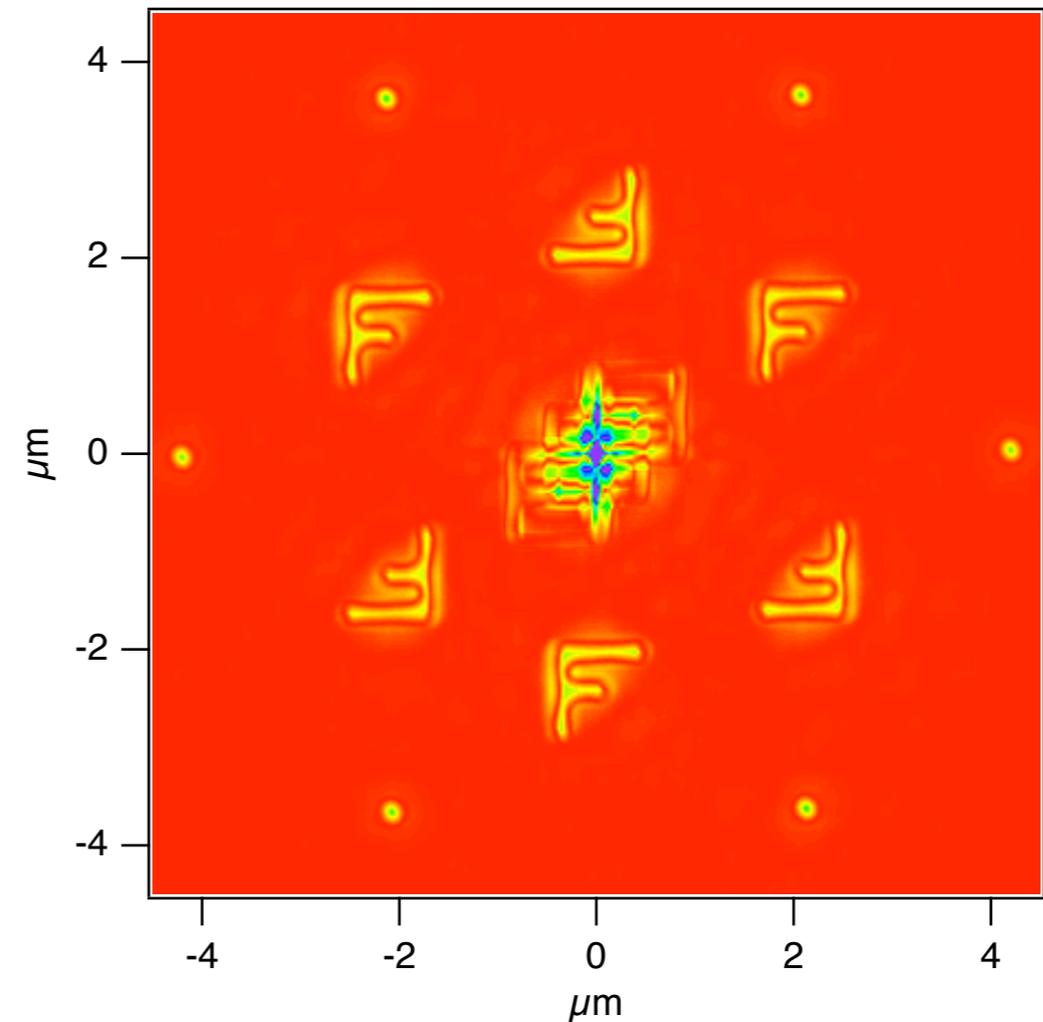
中心部に強いダイレクトビーム  
干渉縞強度はその5桁落ち

# フーリエ変換による再生像

試料SEM像



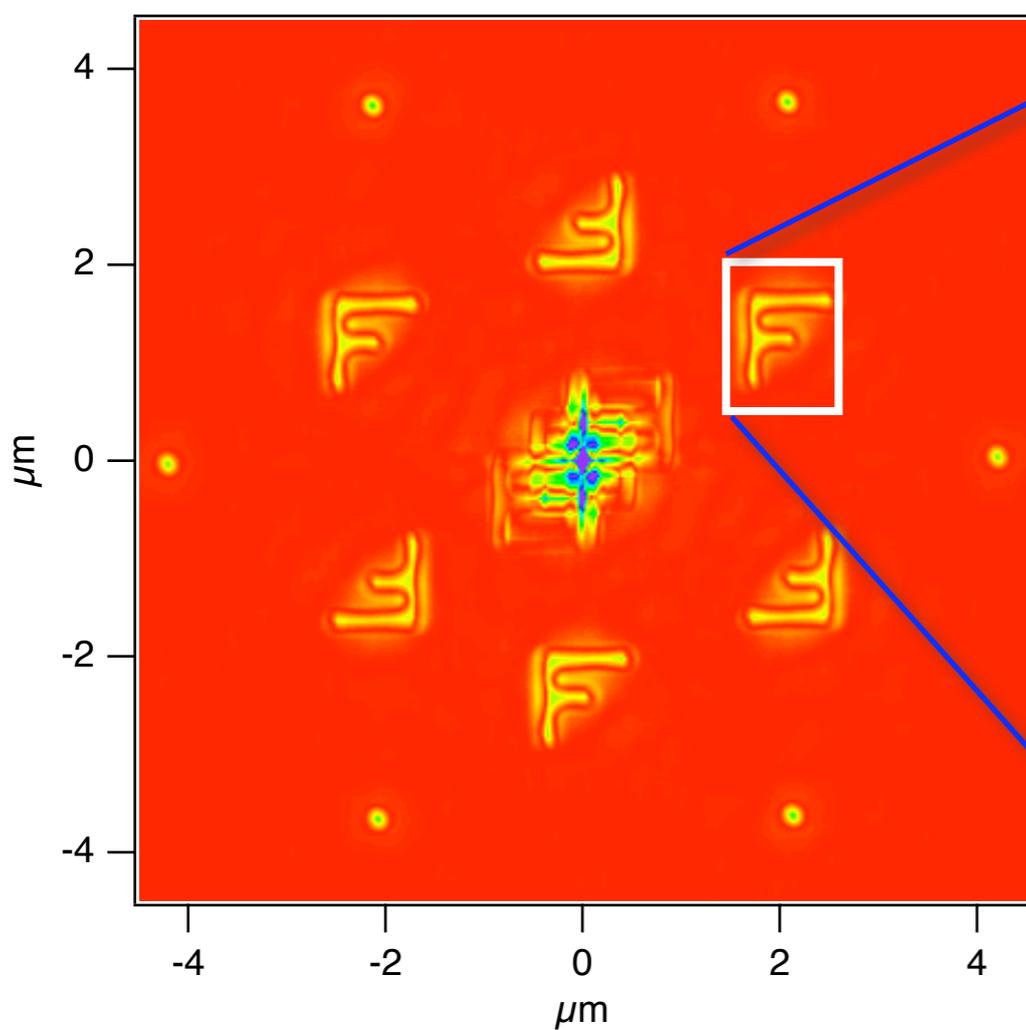
フーリエ変換像



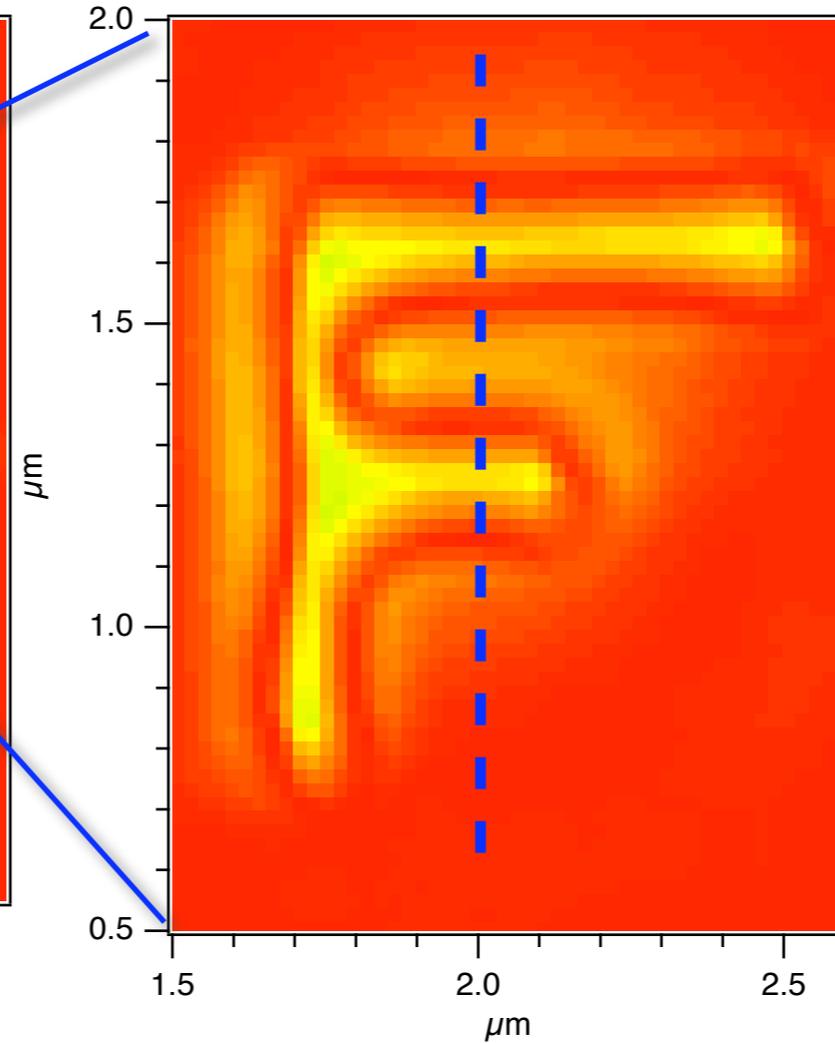
- 'F'パターンの形状を再現 (幅 185 nm)
  - 多重像の記録 (複数の参照光源)
- (回折パターンを中心部をマスクして解析)

# 再生像の分解能

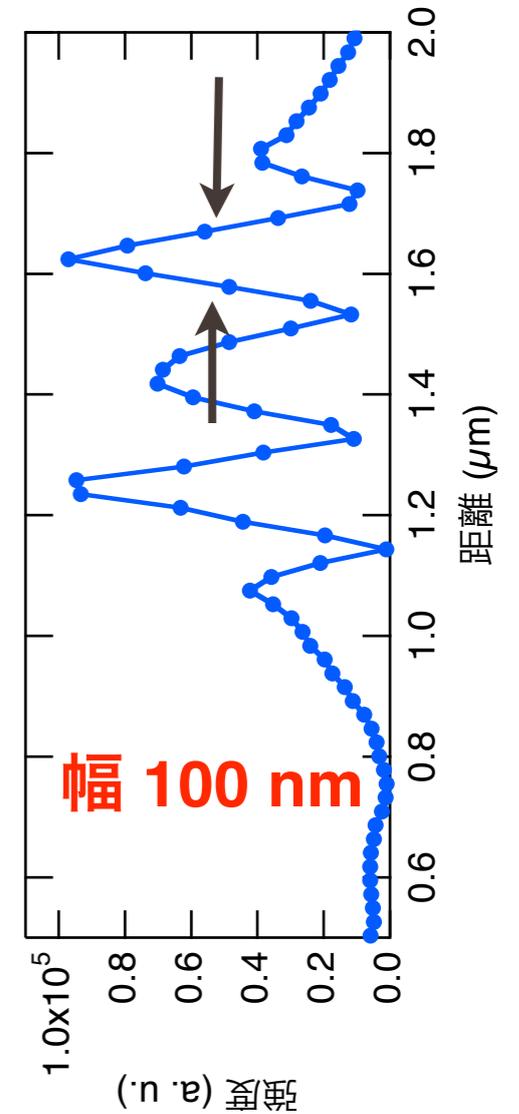
フーリエ変換像



フーリエ変換像 (拡大)



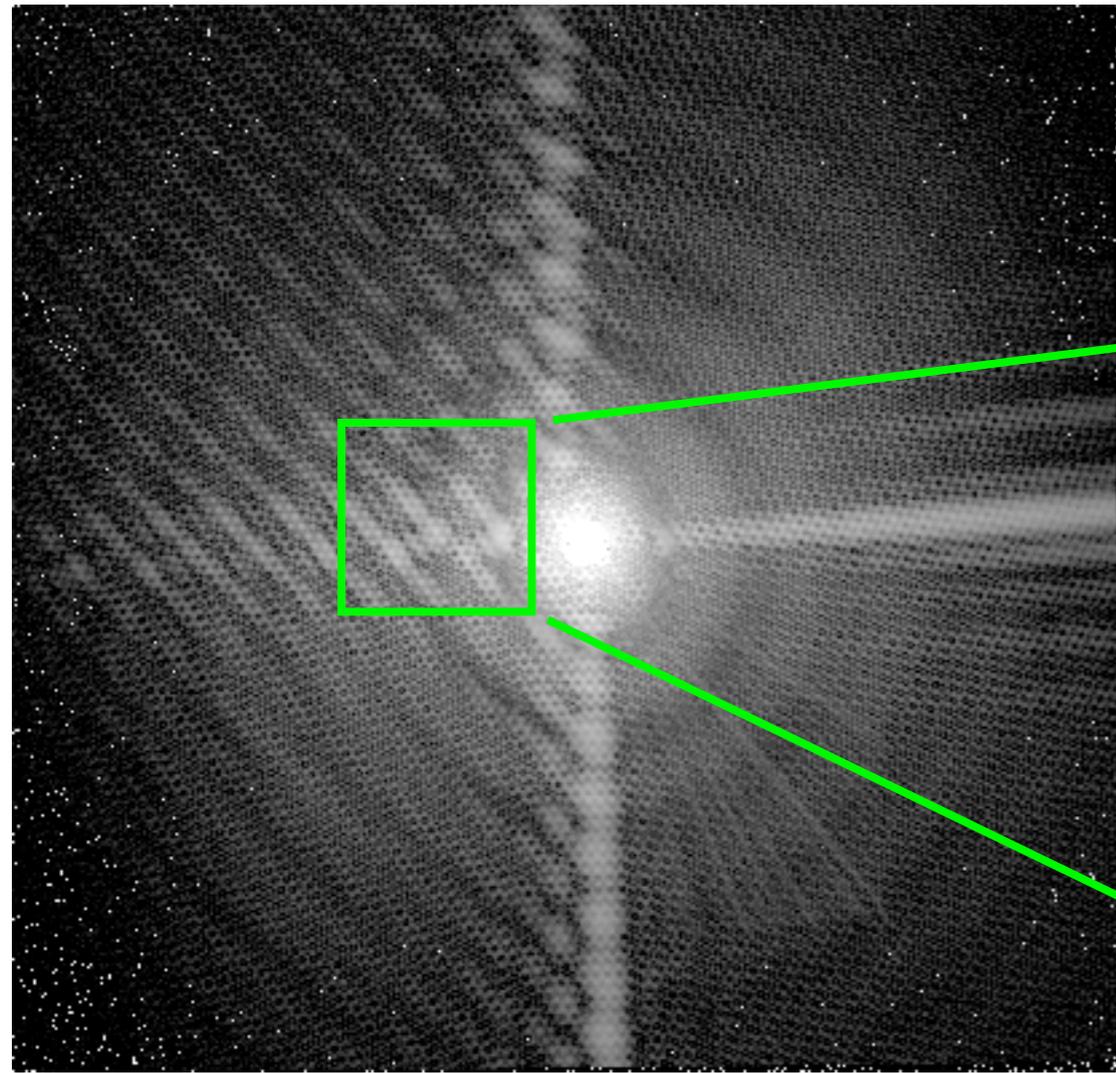
断面図



SEMで見積もった線幅：185 nm

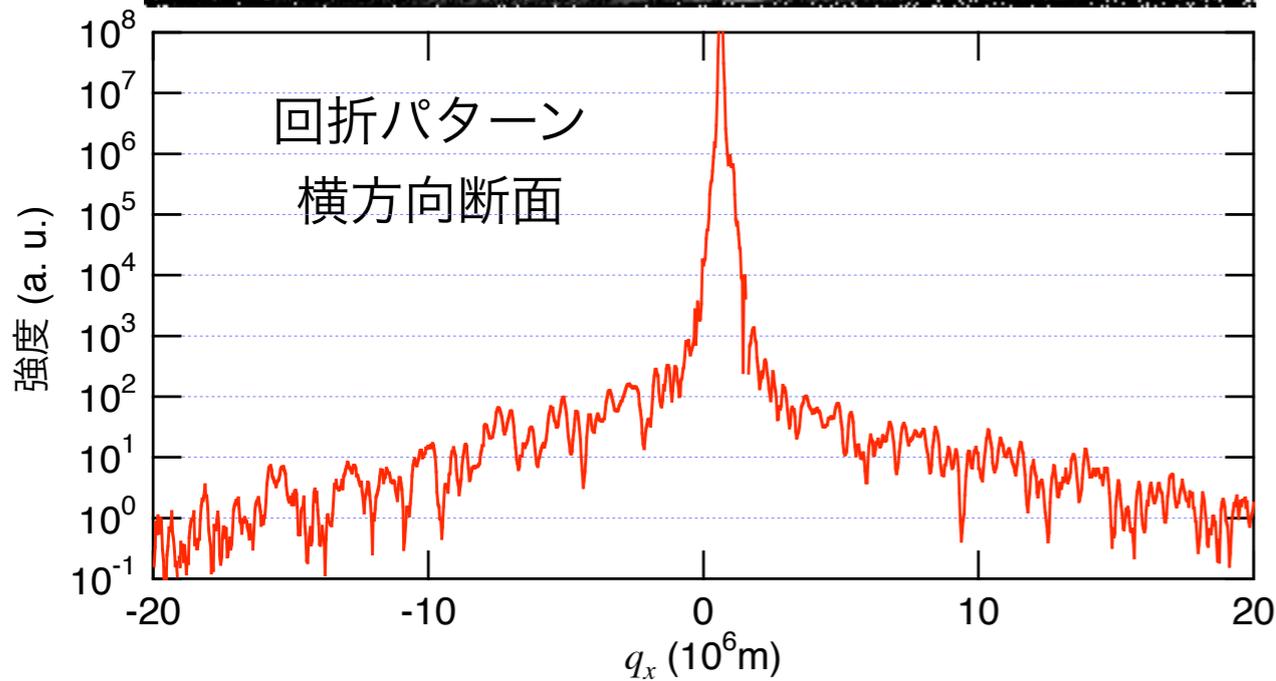
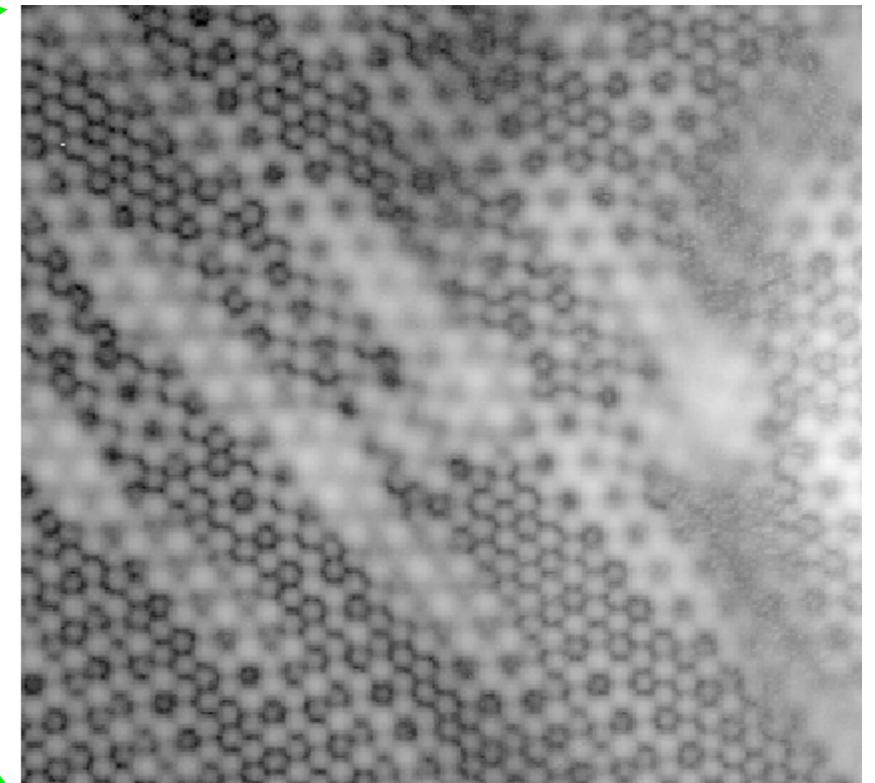
フリッジは  $q_x$  の測定範囲  $< 20 \text{ } (\mu\text{m}^{-1})$  によるものか

# ホログラフィーパターン (凸試料)



回折パターン  
濃淡はログスケール  
 $E = 5 \text{ keV } (\lambda = 2.48 \text{ \AA})$

蜂の巣状の干渉縞



蜂の巣状の干渉縞 → 試料-参照光穴の干渉

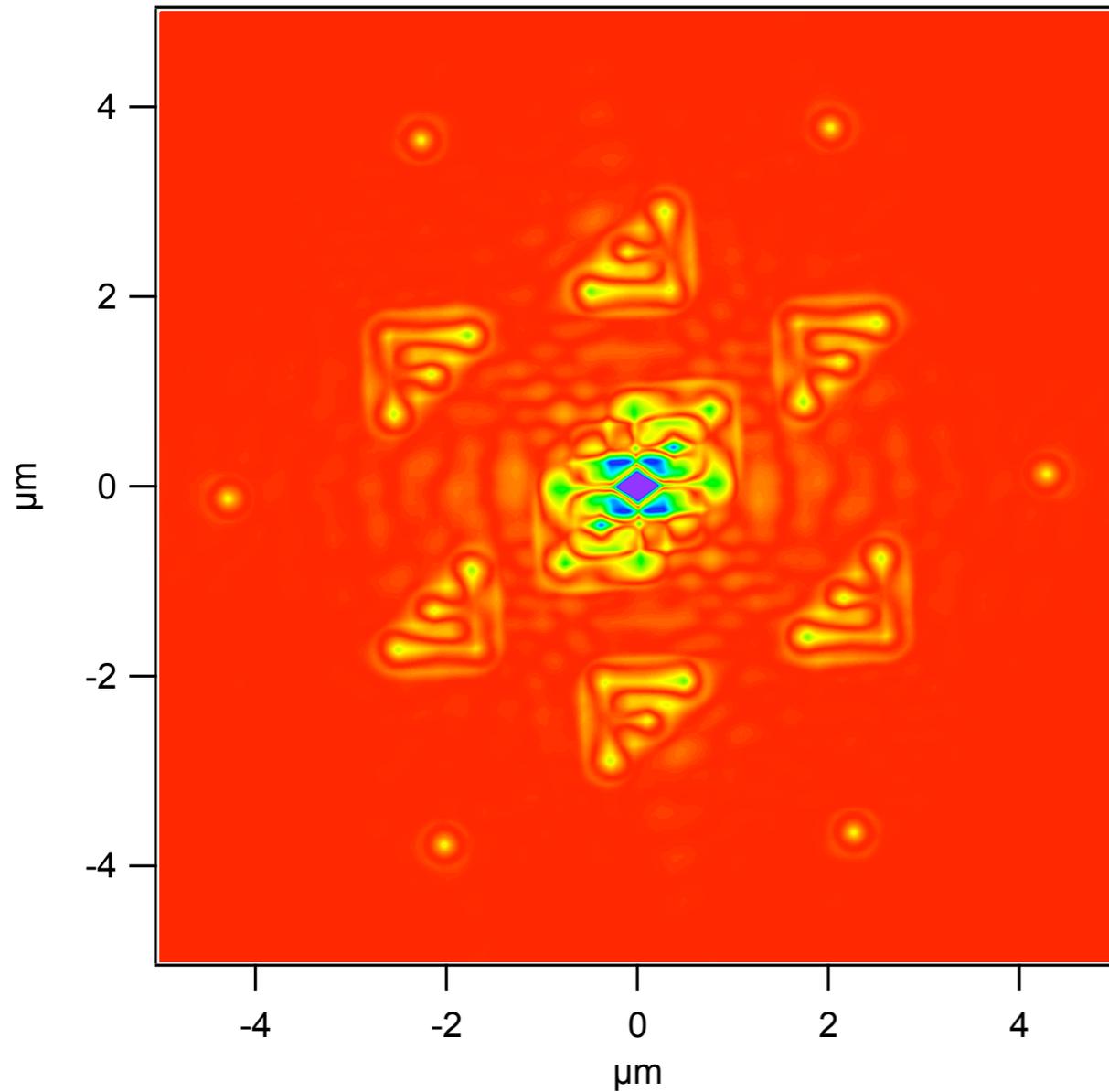
多段階露出 → ダイナミックレンジ8桁

中心部に強いダイレクトビーム  
干渉縞強度はその5桁落ち

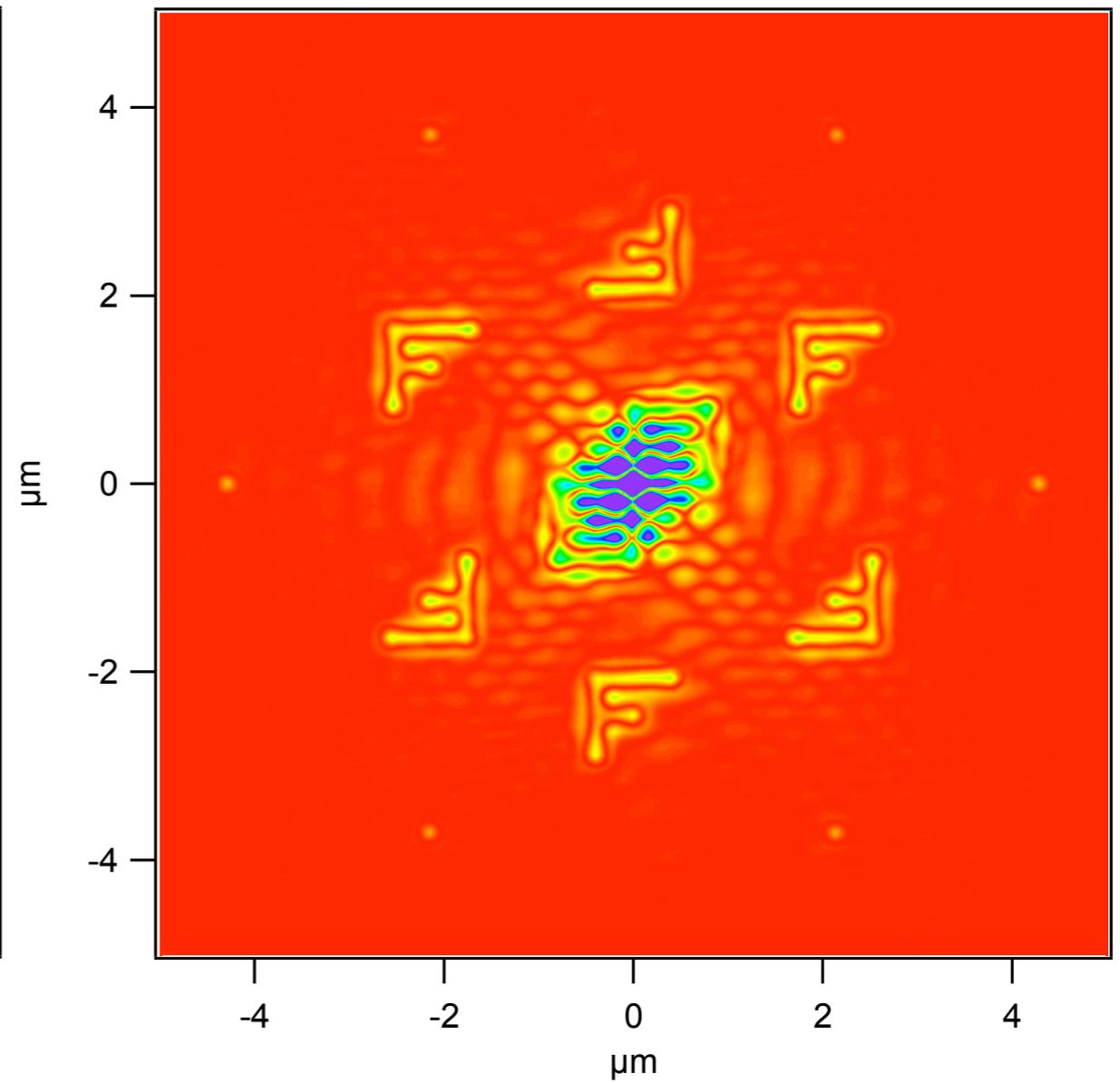
# フーリエ変換による再生像

“凸” 試料

“穴” 試料



線幅240 nm

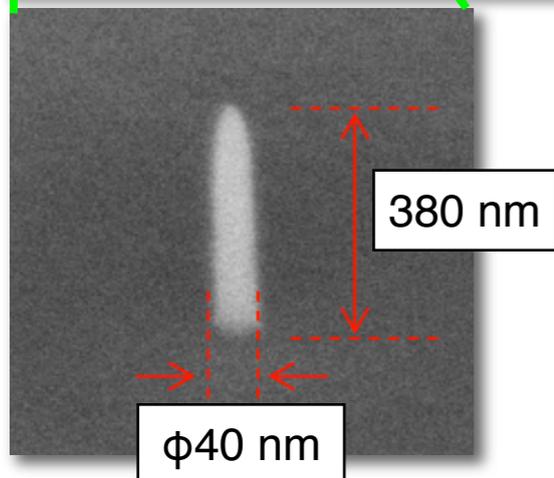
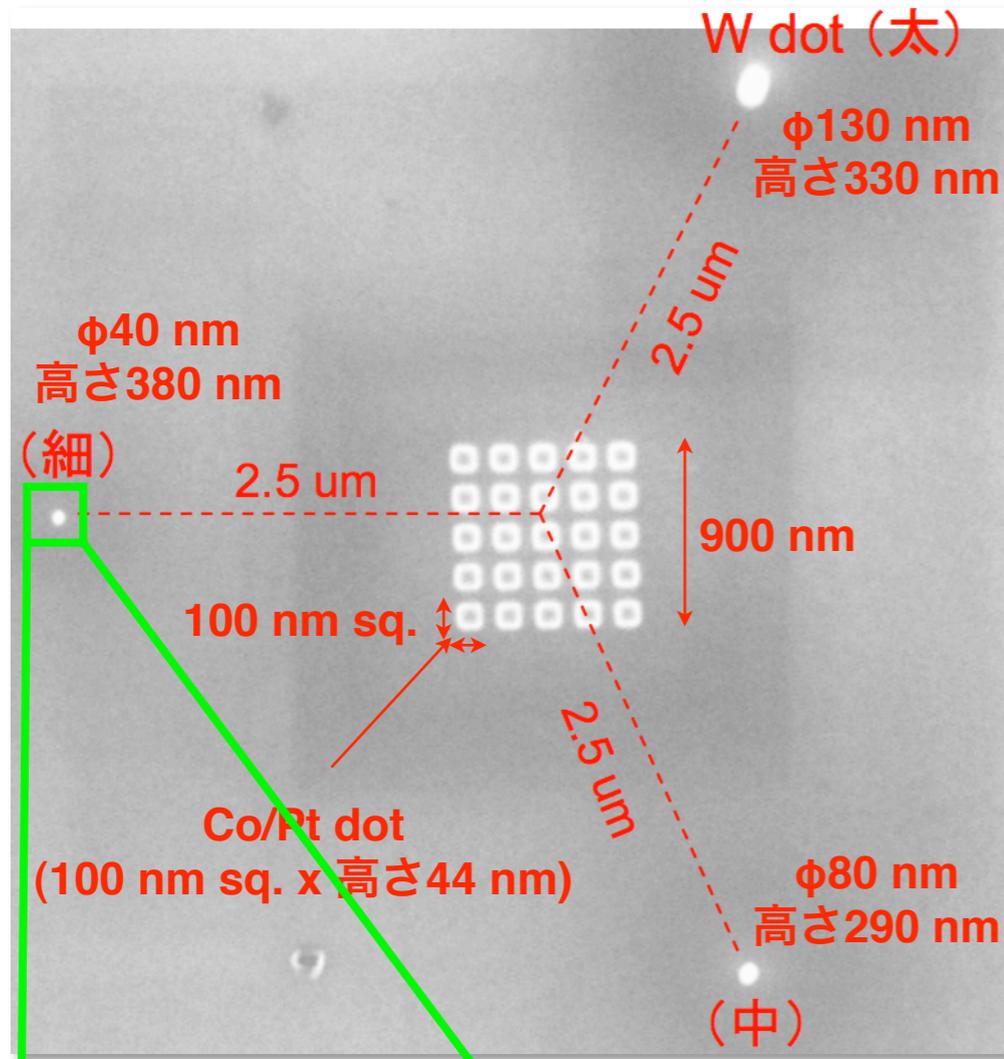


線幅185 nm

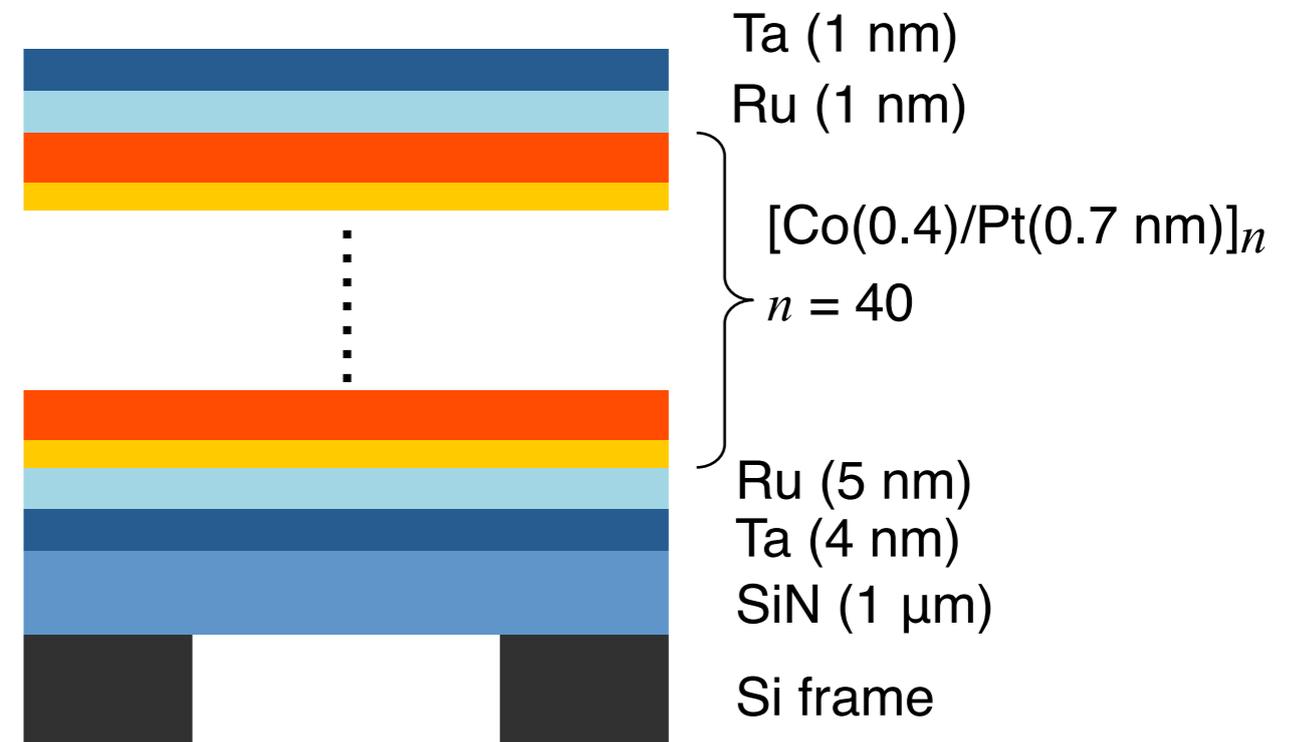
散乱体を参照光源として使用可能

# 硬X線磁気ホログラフィー用試料

(a) SEM 像



(b) 膜構造



Co/Pt 多層膜 ( $n = 40$ , 厚さ 44 nm)

1  $\mu$ m 厚 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> メンブレン上に成膜

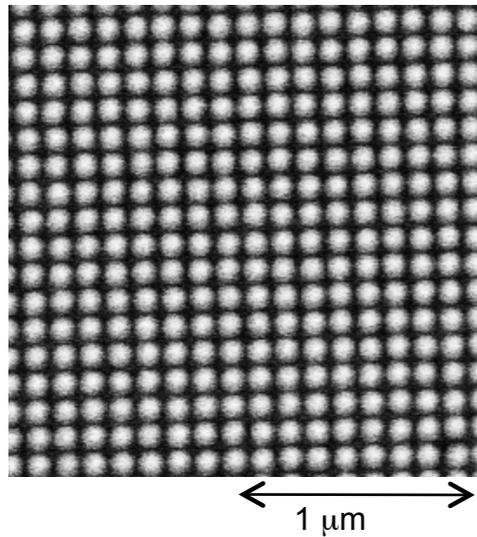
参照光源物体: 高アスペクト比のW製ピラー  
電子ビームアシスト-CVD法で形成

# ドットの磁化過程での磁気イメージング

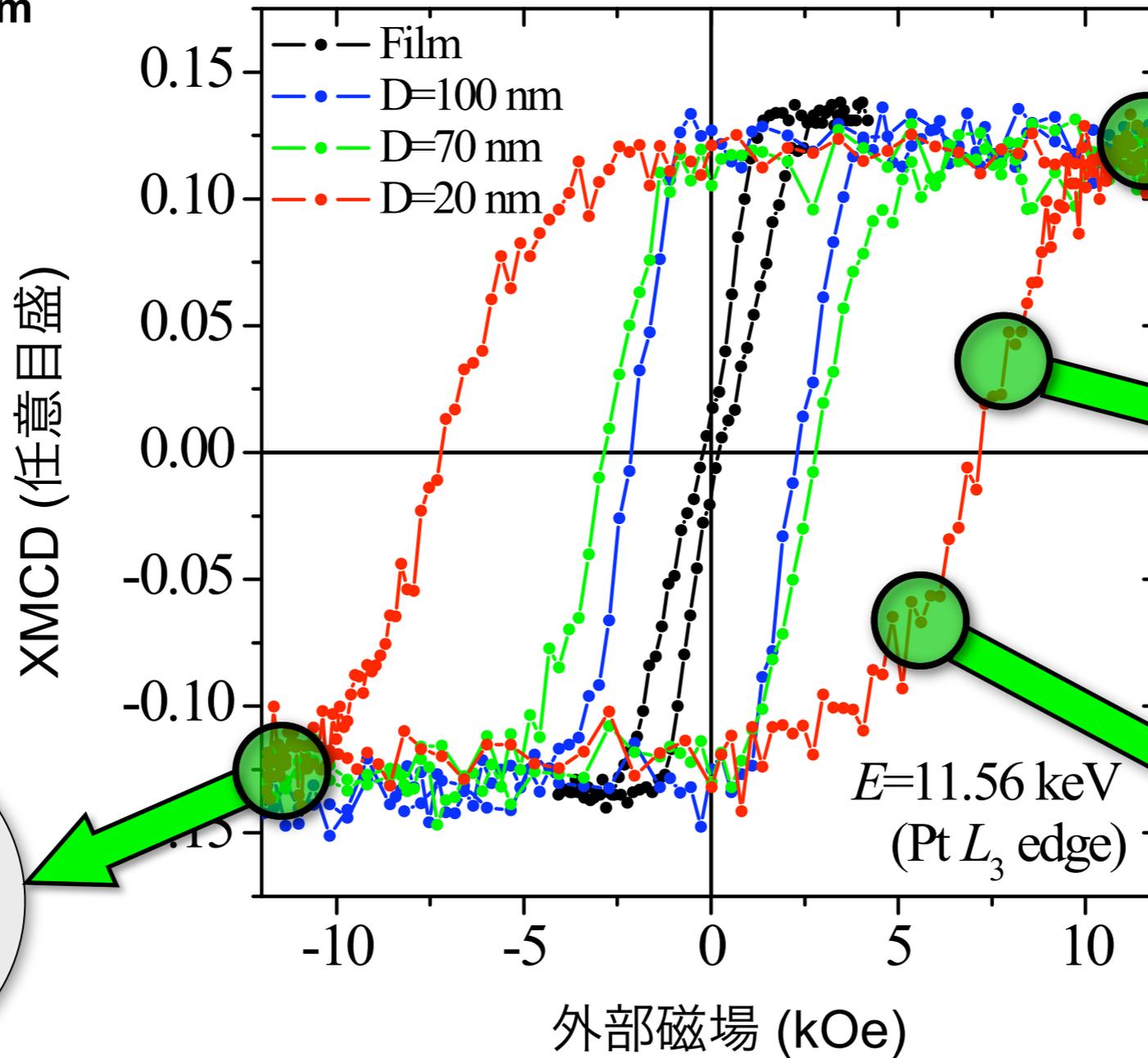
磁性膜構成:  $\text{Co}_{80}\text{Pt}_{20}/\text{Au}/\text{Ti}$

ドット径: 100, 70, 20 nm

ピッチ: 100 nm



20 nm径ドット



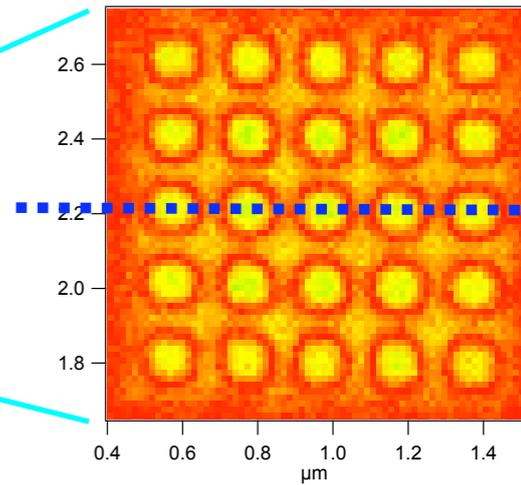
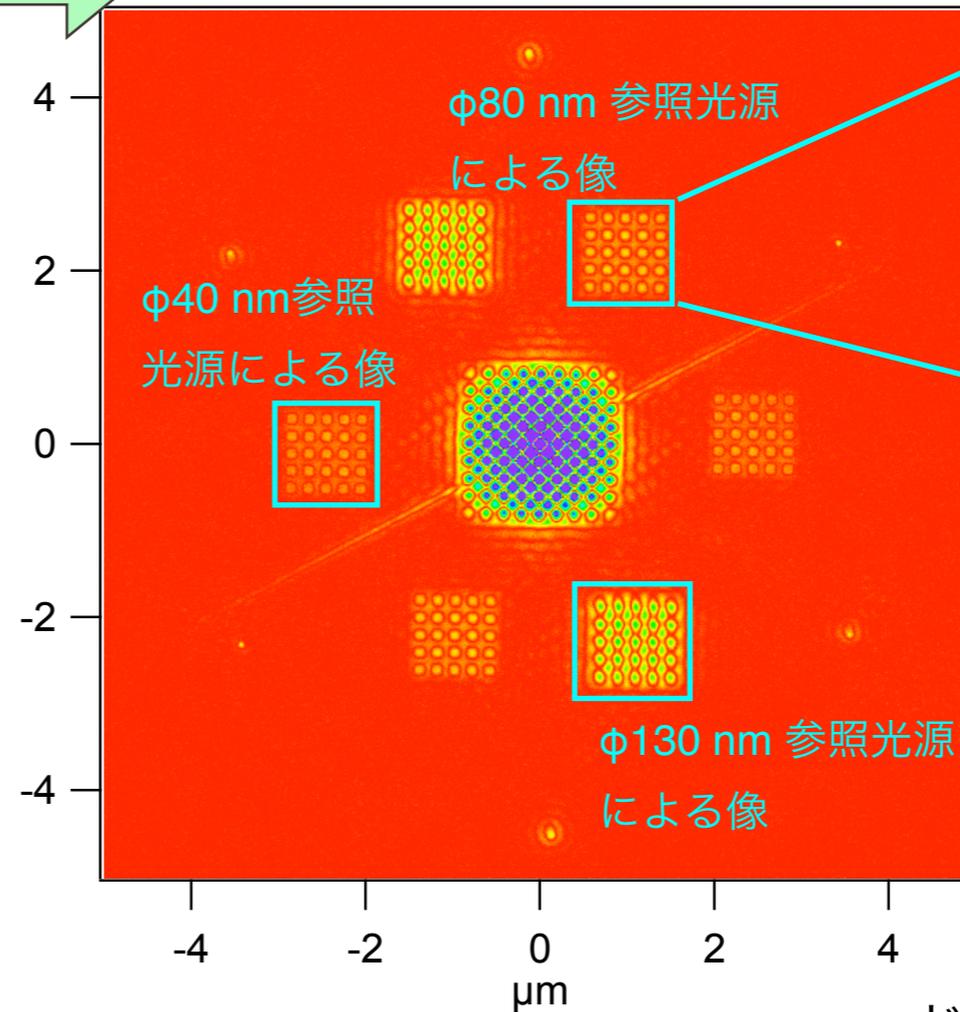
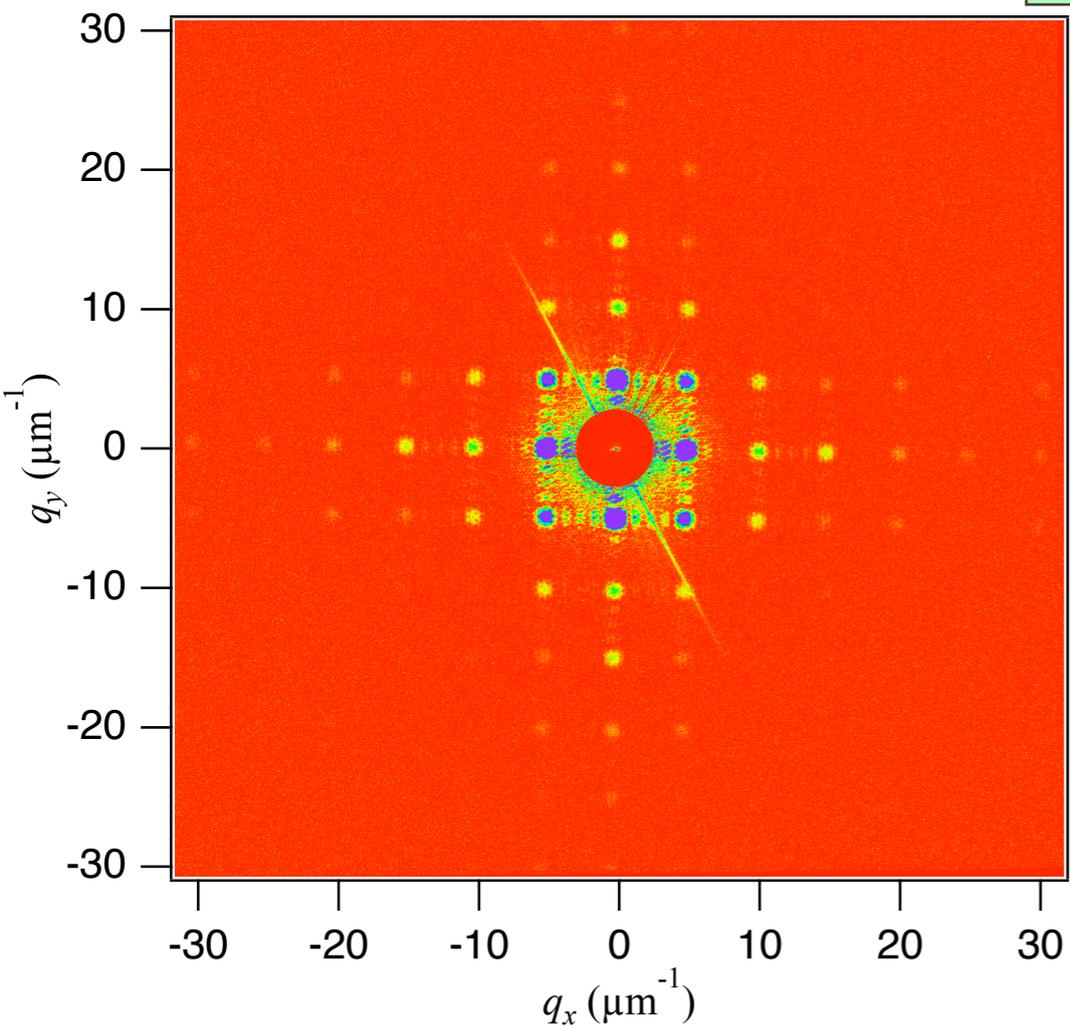
ビットパターン媒体の磁化反転過程に関する情報  
 スイッチング磁場分散 (SFD) との関係

# 電荷ホログラフイー像

ホログラム

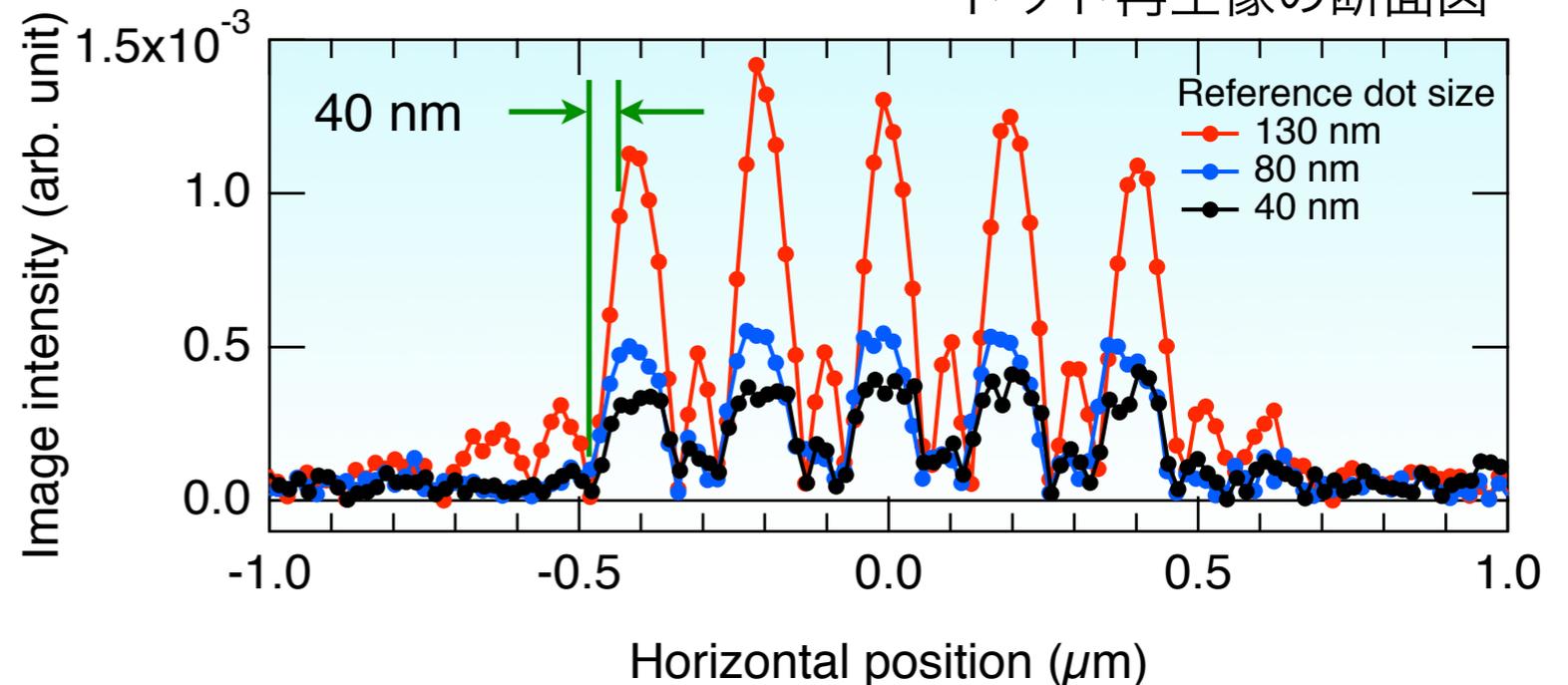
FFT

フーリエ変換像



拡大図:  
φ80 nm 参照光源によるドット再生像

ドット再生像の断面図

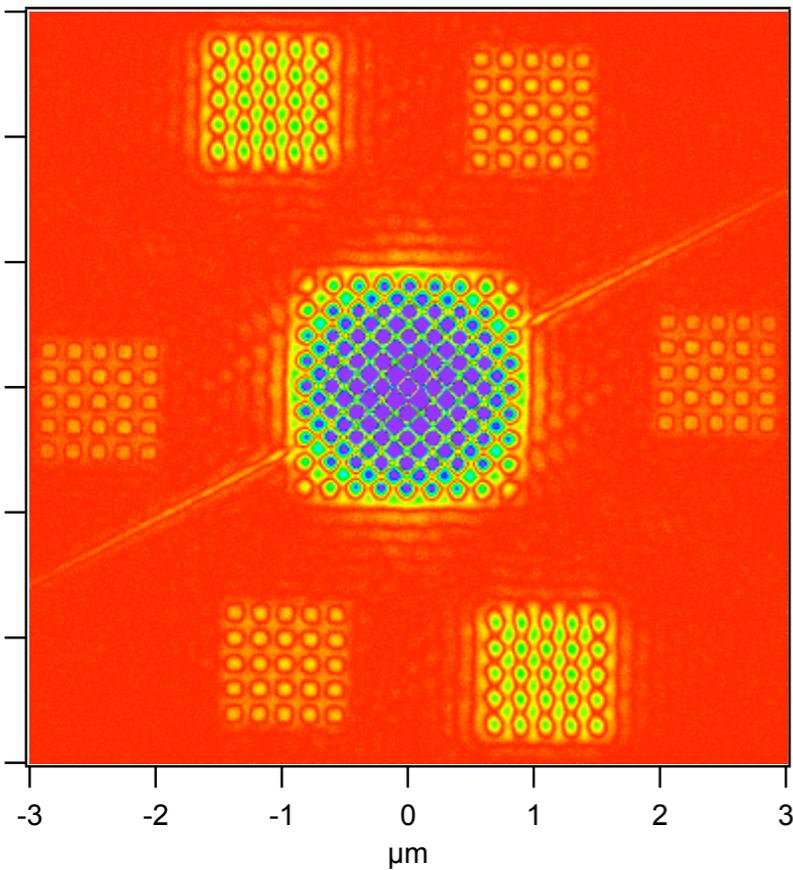


- Pt  $L_3$ 吸収端:  
X線エネルギー 11.562 keV ( $\lambda = 0.107$  nm)
- 右回り円偏光
- 試料-CCD距離: 3.95 m
- 試料は交流消磁

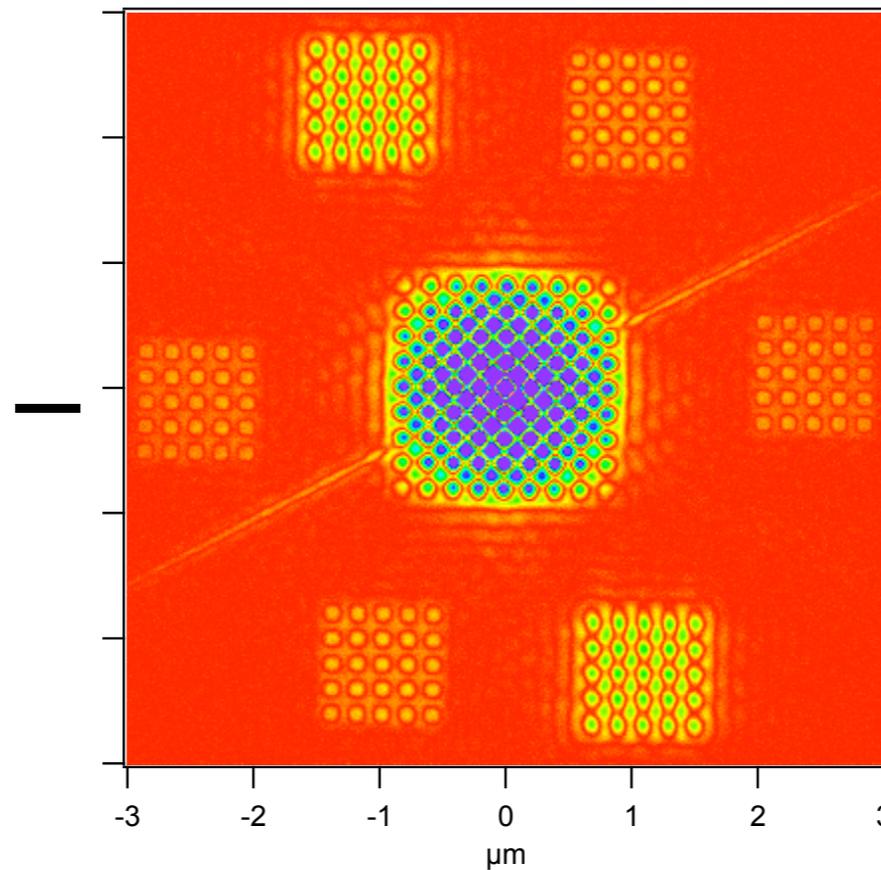
# 磁気ホログラフィー像

左右円偏光に対する電荷像の差分@Pt L<sub>3</sub>吸収端

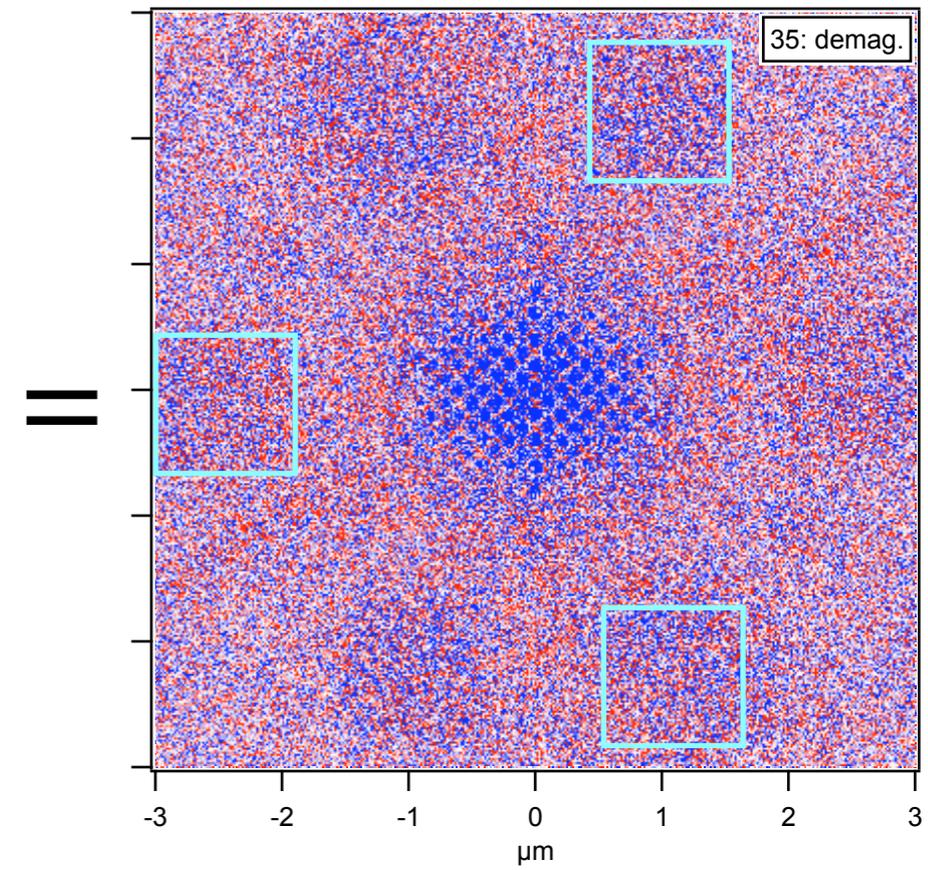
右回り円偏光



左回り円偏光



差分 (磁気像)



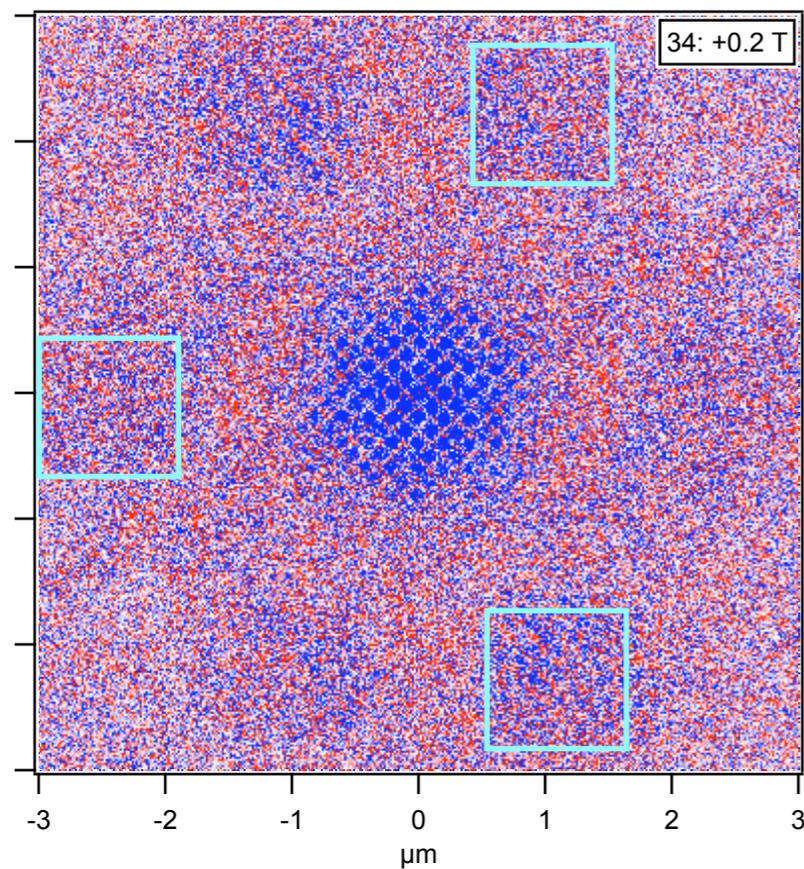
\*試料は消磁状態

磁気ドット位置に、なんらかの磁気的信号

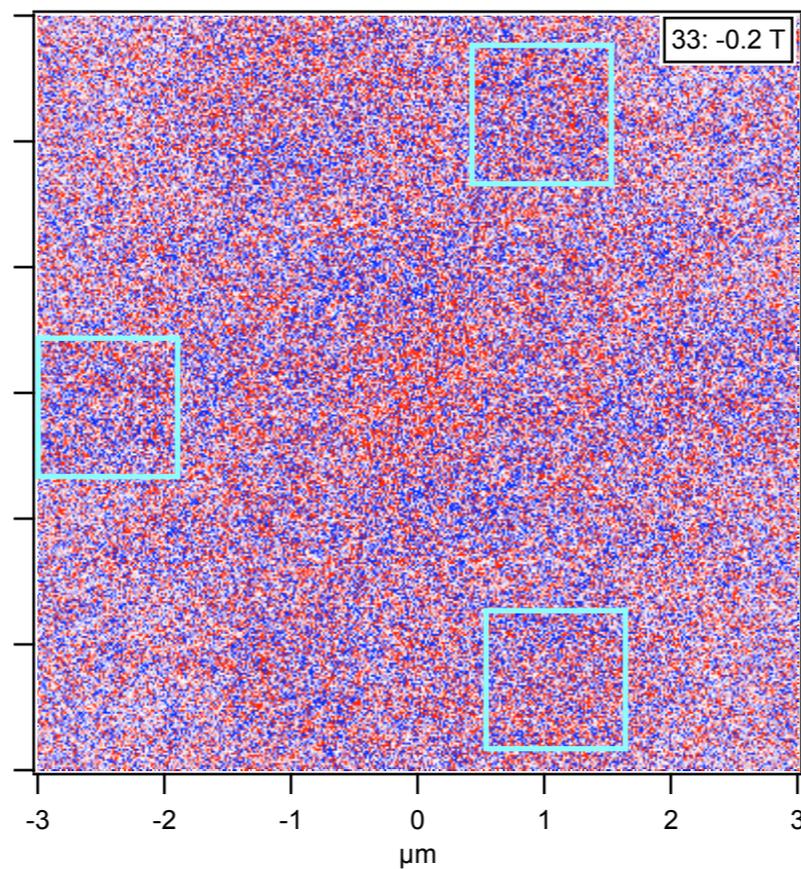
# 磁気ホログラフィー像

左右円偏光に対する電荷像の差分

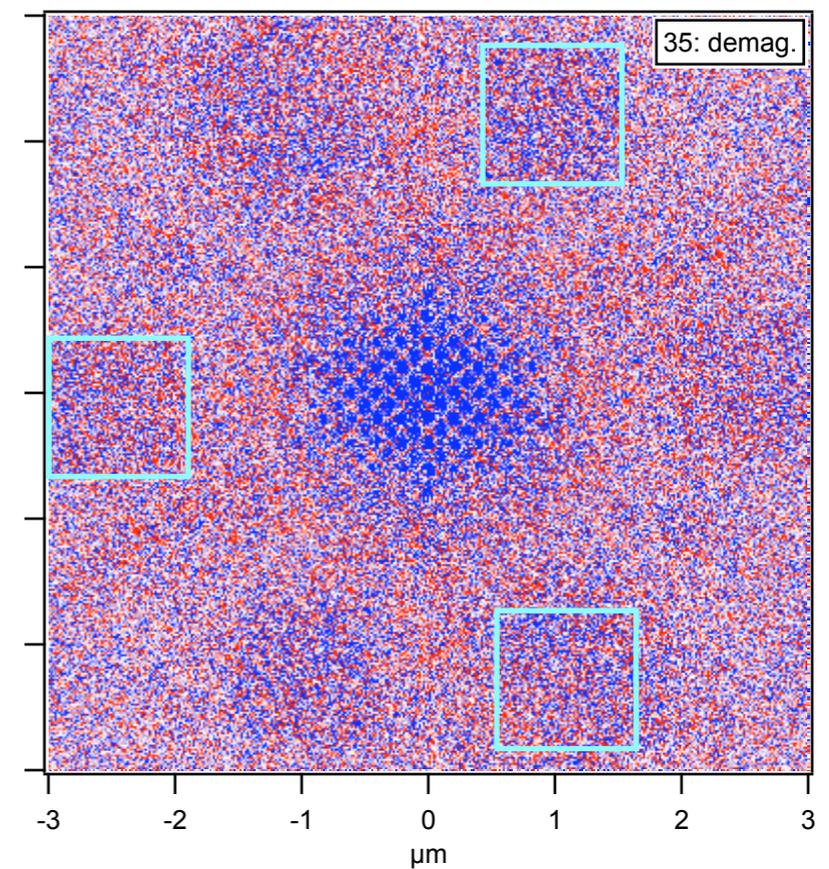
(a)  $H = +0.2$  T



(b)  $H = -0.2$  T



(c) 消磁状態

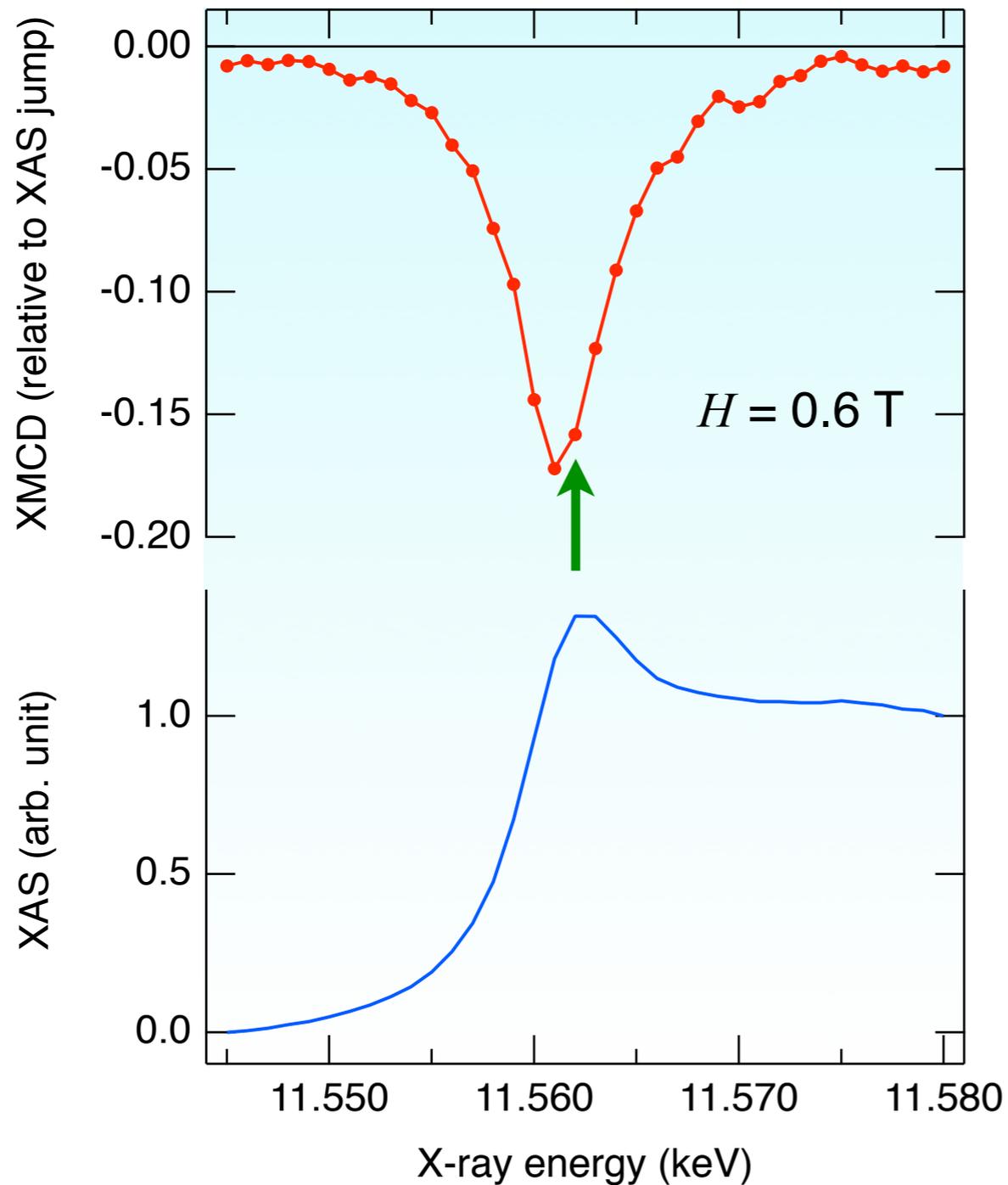


試料の磁区変化に対応した磁気像の変化を観測

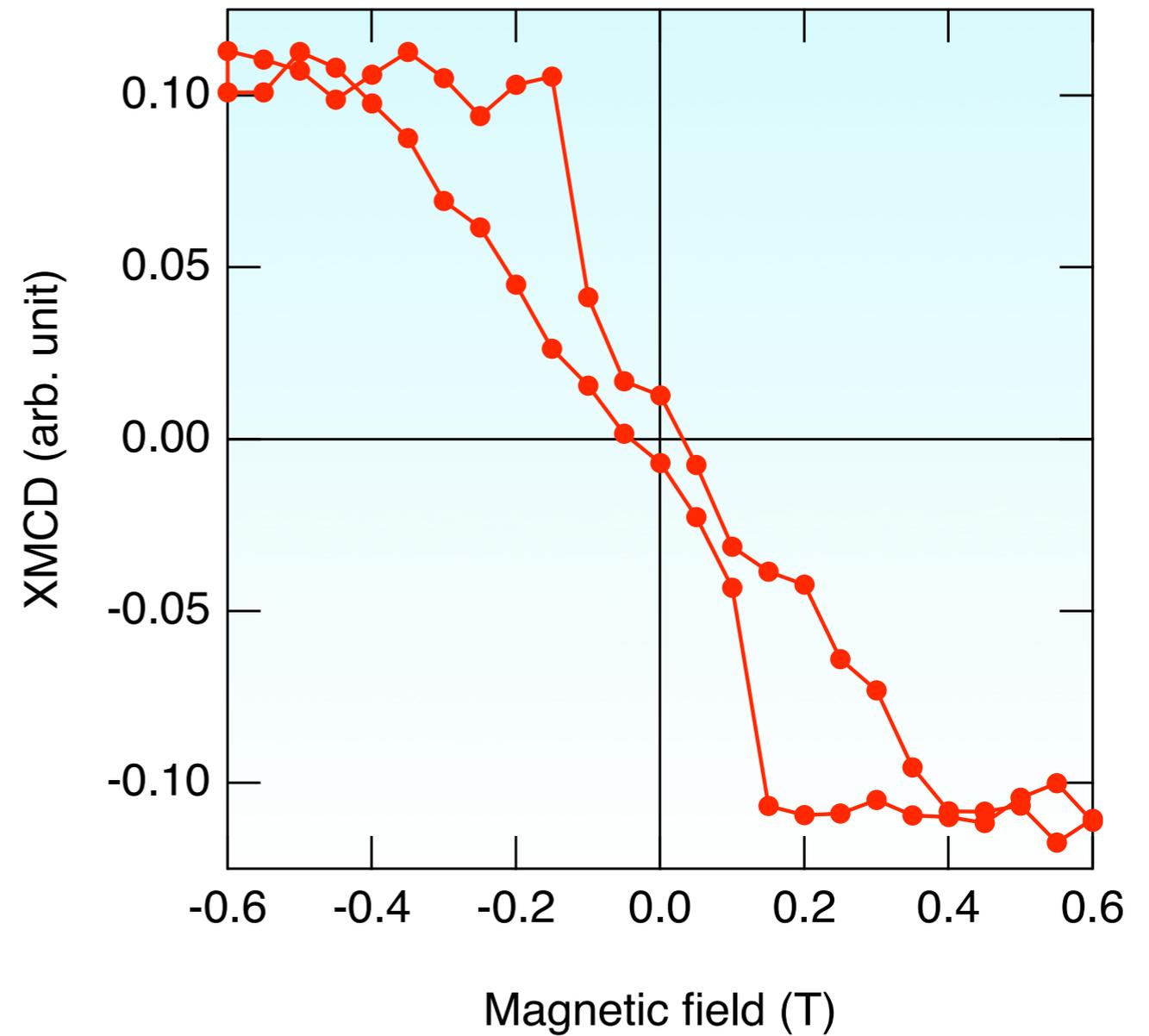
磁気コントラスト  $\doteq$  S/N比

# XMCDおよび元素別磁化曲線 (Co/Pt連続膜)

XMCDスペクトル (Pt L<sub>3</sub>端)

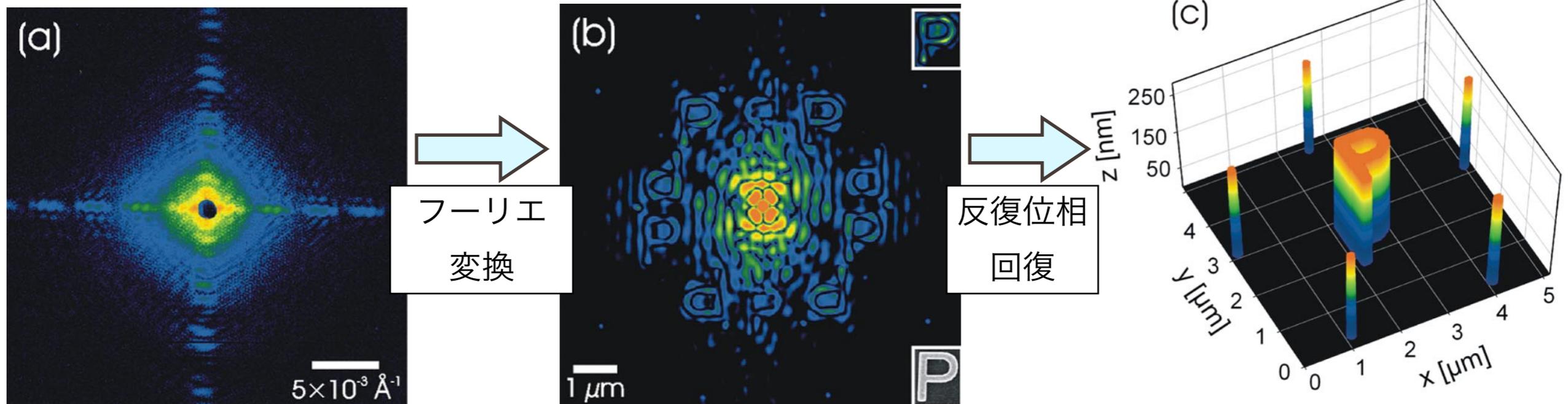


元素別磁化曲線 (Pt)



# 反復位相回復法との組み合わせ

## 硬X線ホログラフィー + 反復位相回復による像再生



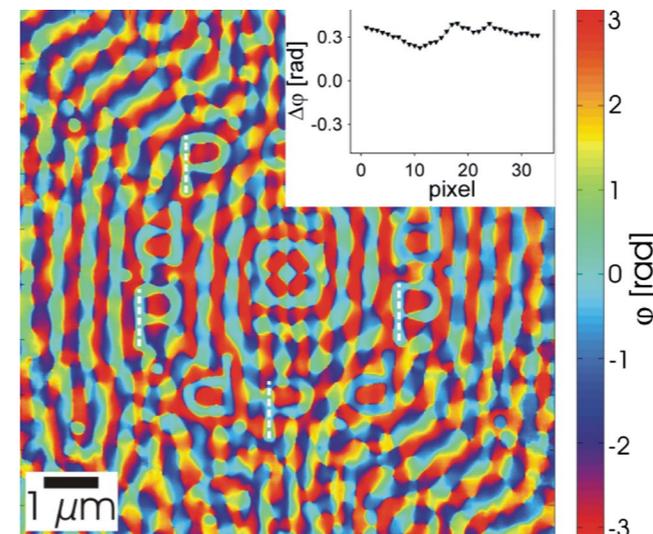
ホログラム像

波長: 1.55 Å (8 keV)

試料: "P" 型パターン、幅200 nm

参照光物体: Au ドット175 nm径 × 5個

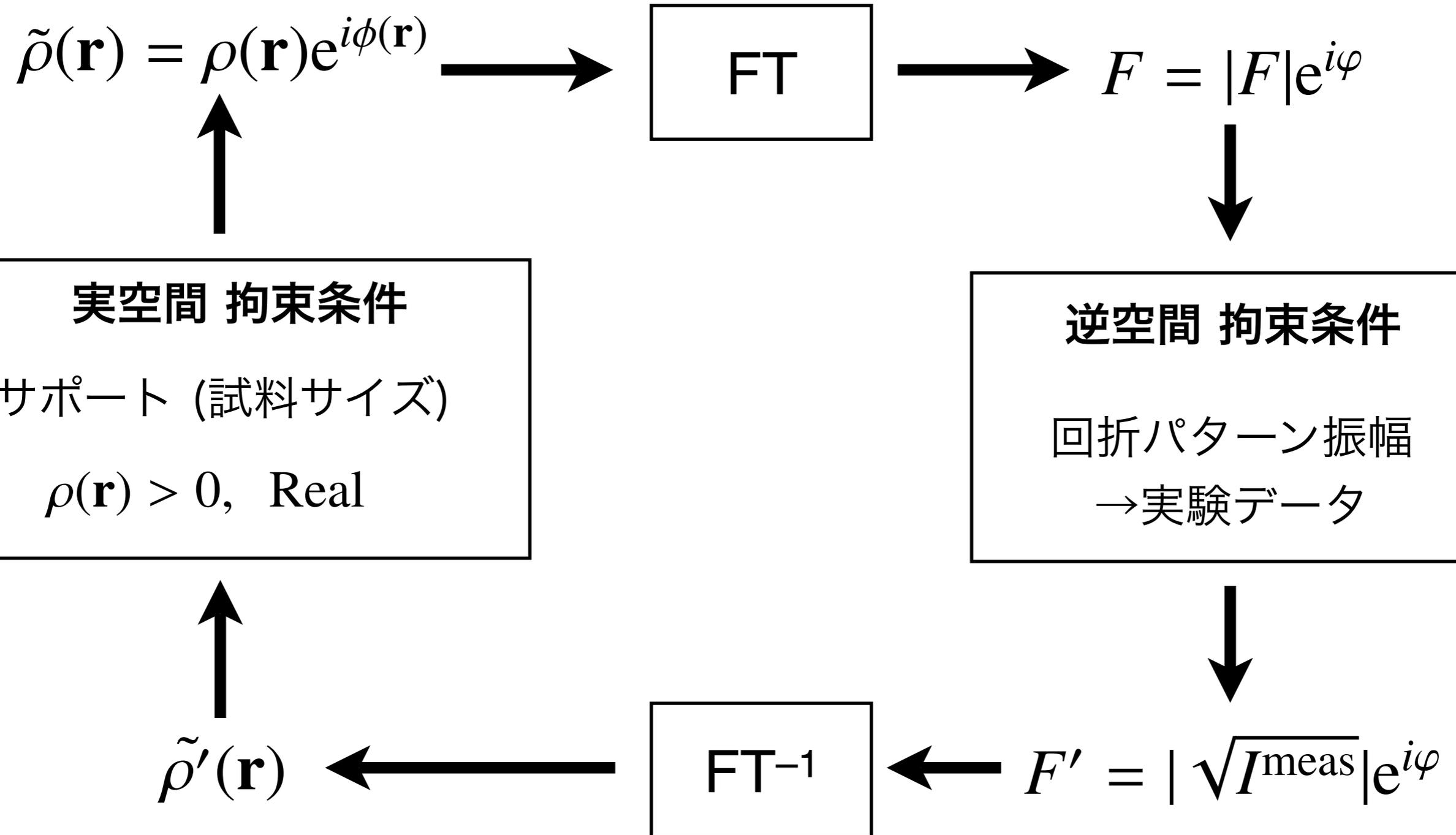
@ESRF ID10C



位相マッピング

空間分解能: 25 nm

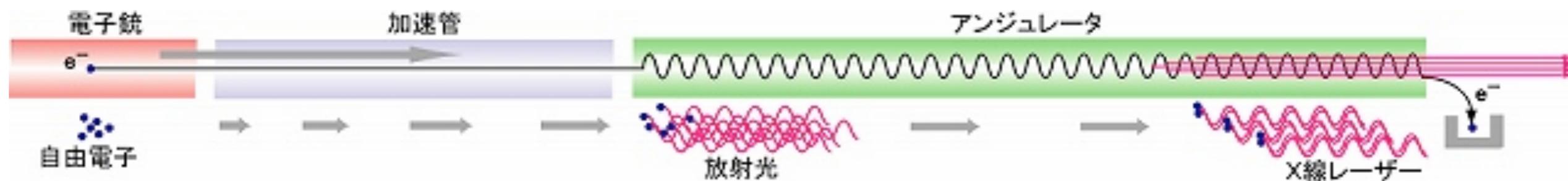
# 通常有位相回復アルゴリズム (ER/HIO)



# XFEL (X線自由電子レーザー)



SPring-8キャンパスに建設中のXFEL施設 (2010年度完成予定)



- ・ X線領域 ( $\lambda = 0.1 \text{ nm}$ ) のレーザー光源
- ・ 非常に高い瞬間輝度 (SPring-8の10億倍)
- ・ 超短パルス ( $\sim 10 \text{ fs}$ )
- ・ コヒーレンス特性

X線の干渉性を用いたイメージングにより、ps  $\sim$  fsの物理化学現象を観察

# ブラッグ反射配置での回折磁気スペックルの計測

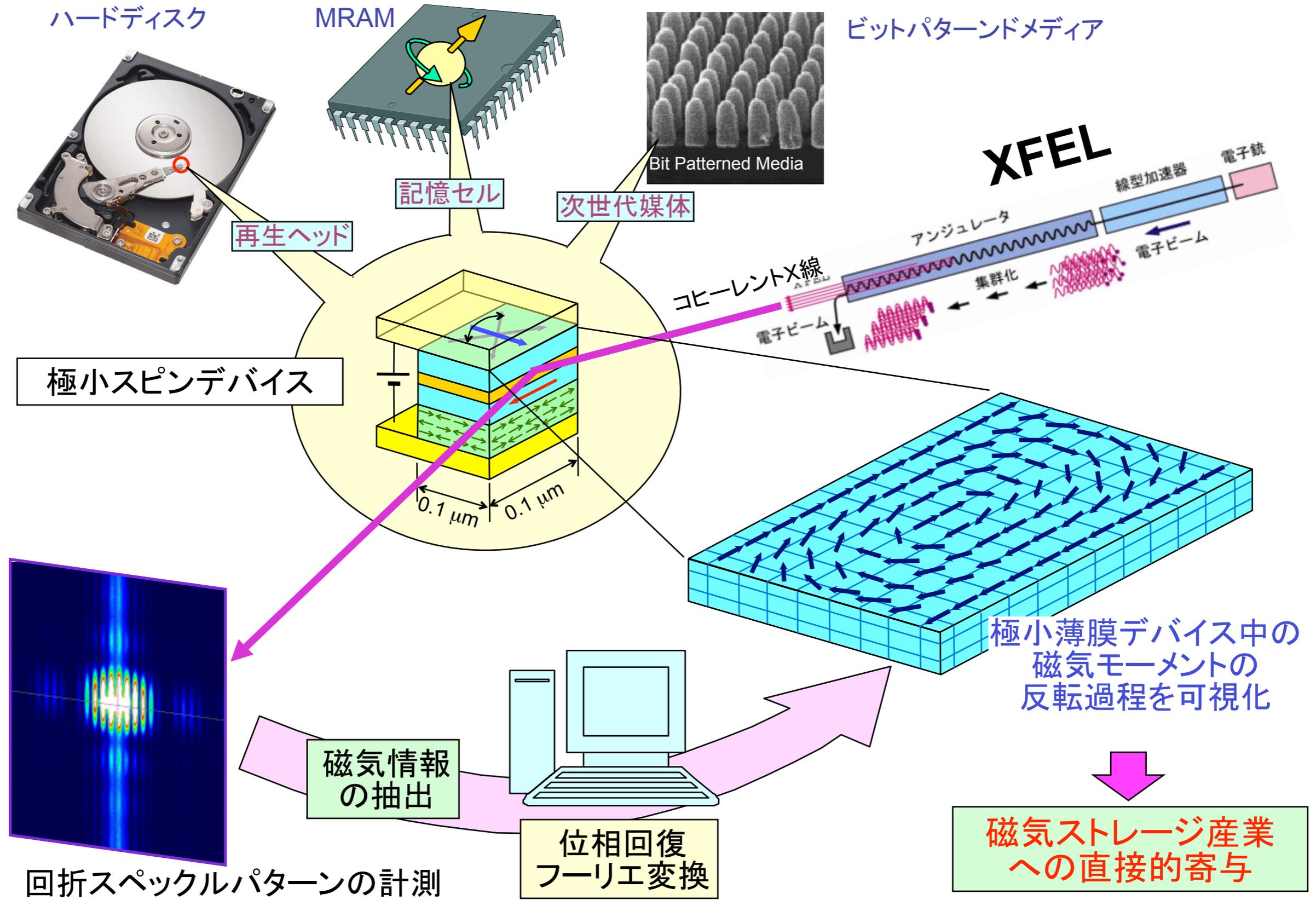
ブラッグ回折スポットに現れるコヒーレント散乱パターン

偏光+共鳴→磁気回折スペックル→磁区の可視化

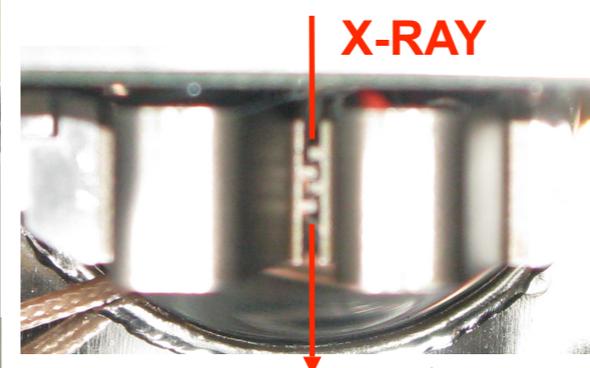
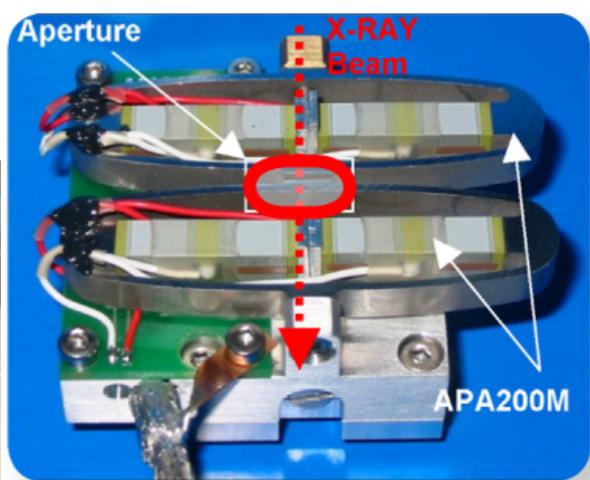
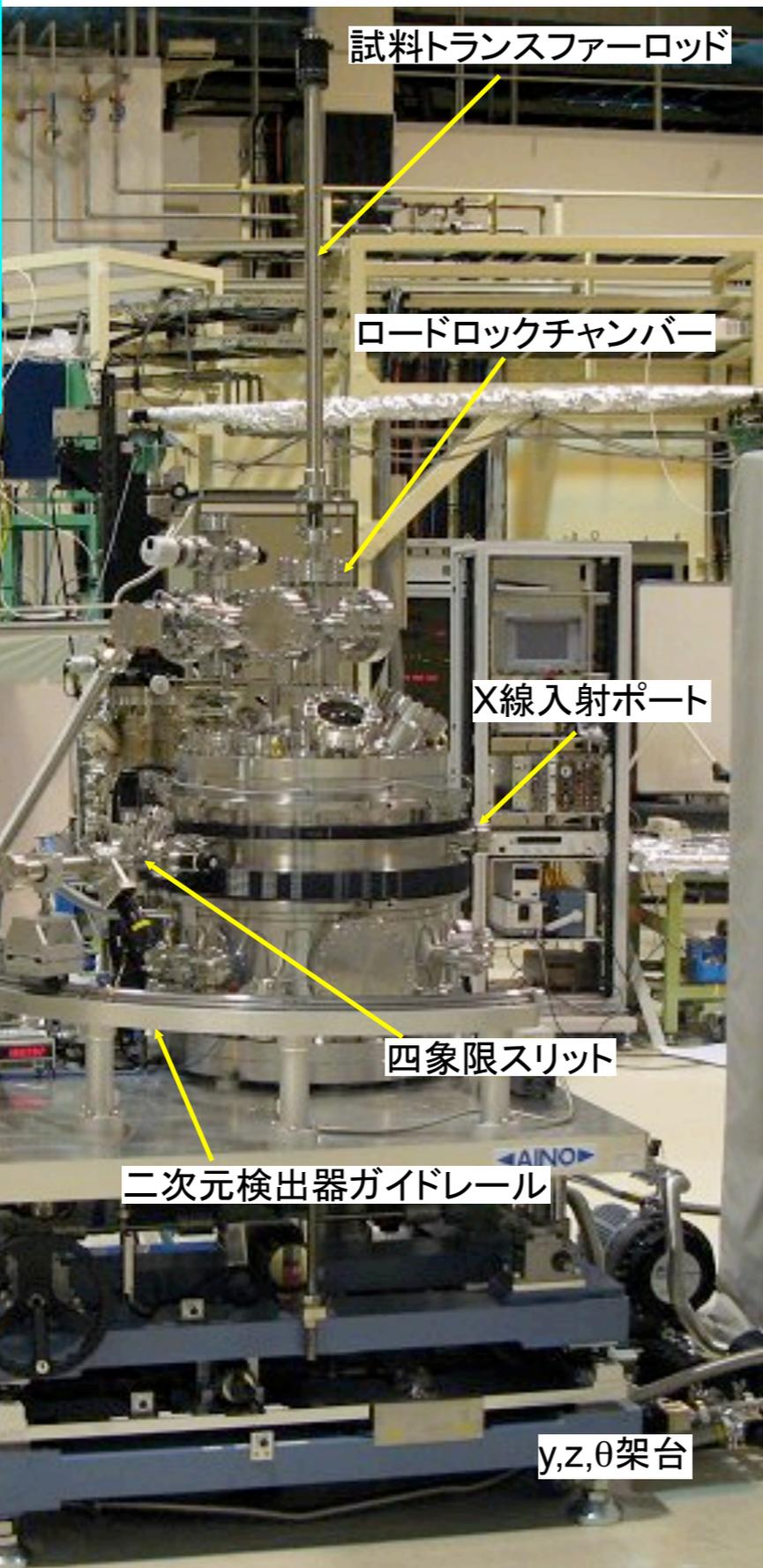
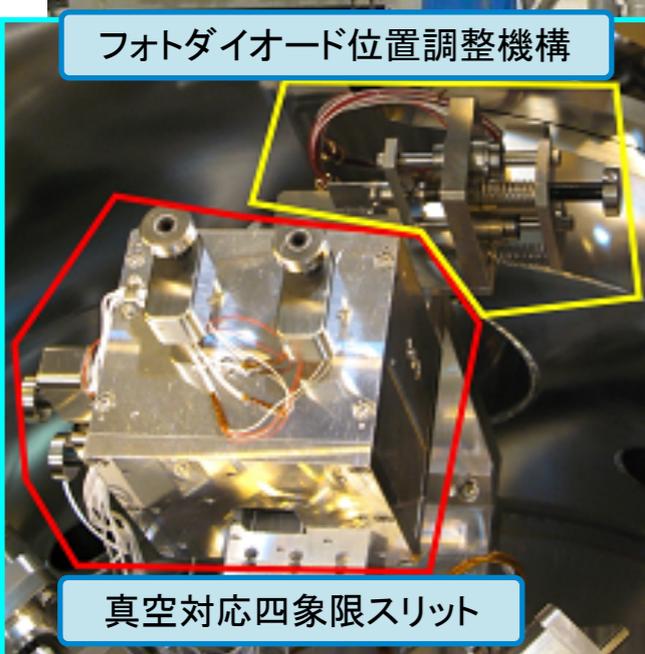
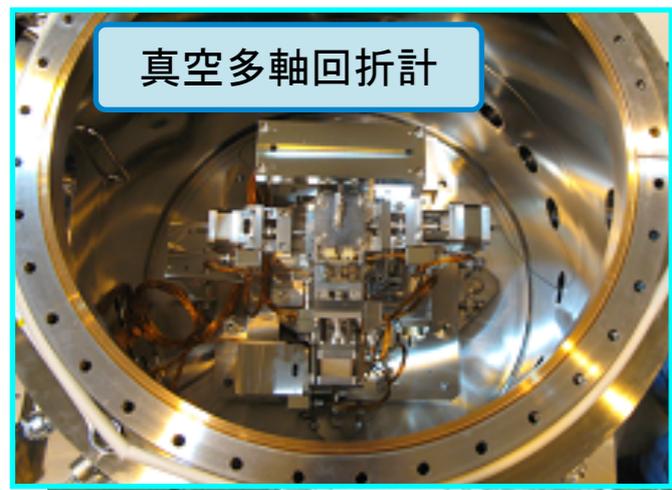
角田 (東北大)

淡路 (富士通)

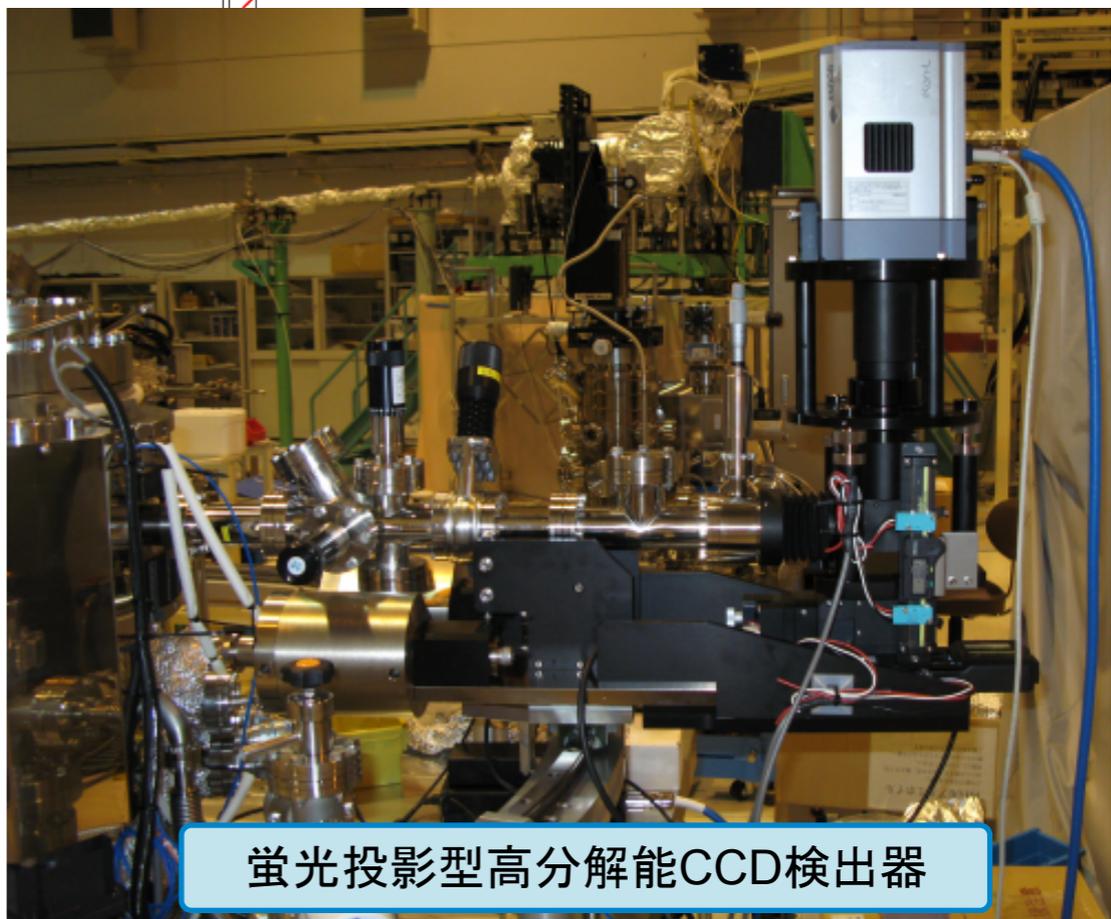
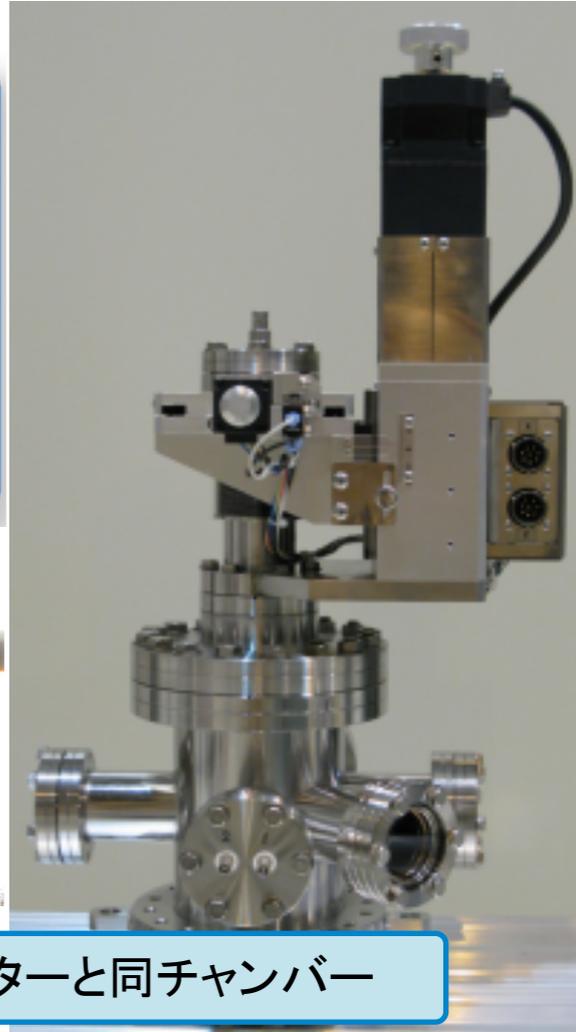
中村、鈴木 (JASRI)



# 回折スペックル計測装置の整備状況

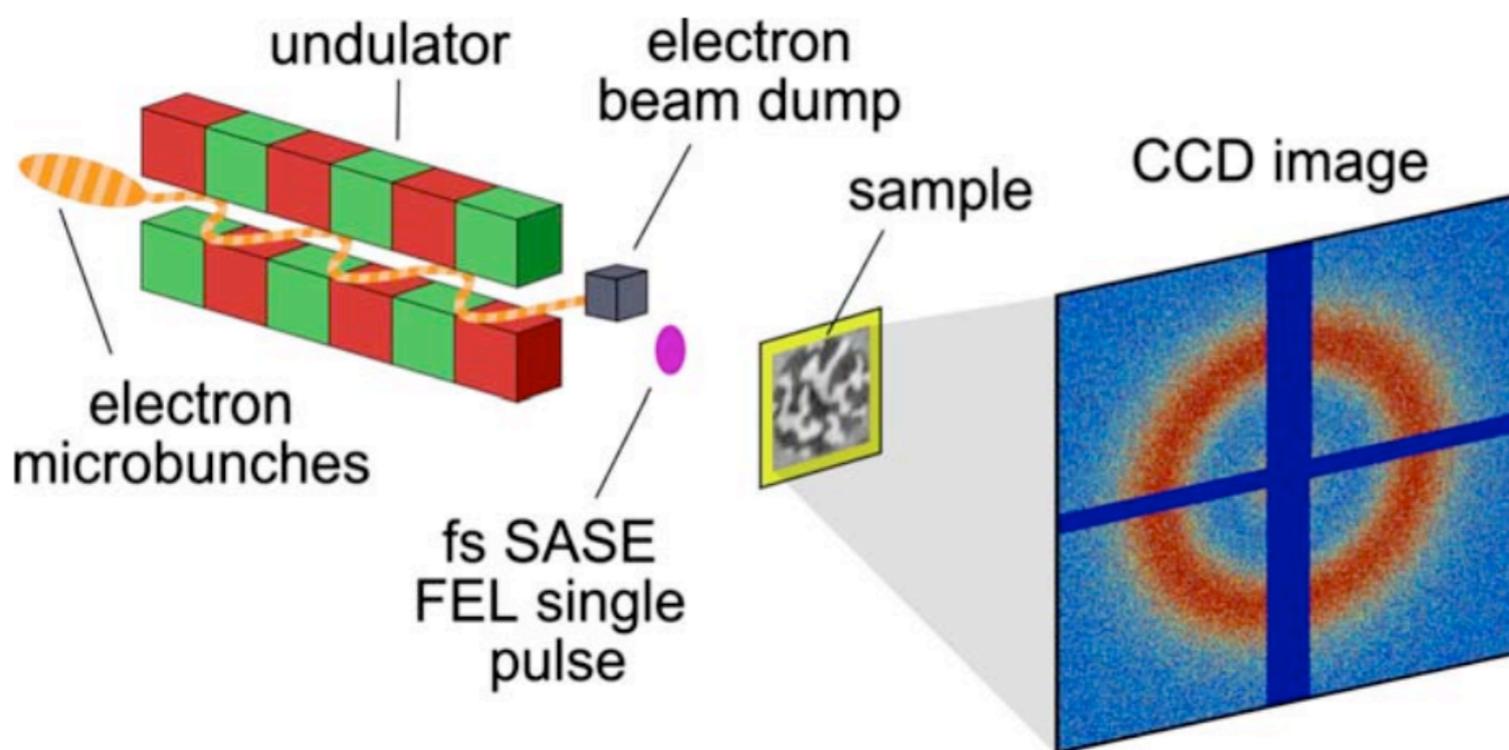


高速ピエゾシャッターと同チャンバー

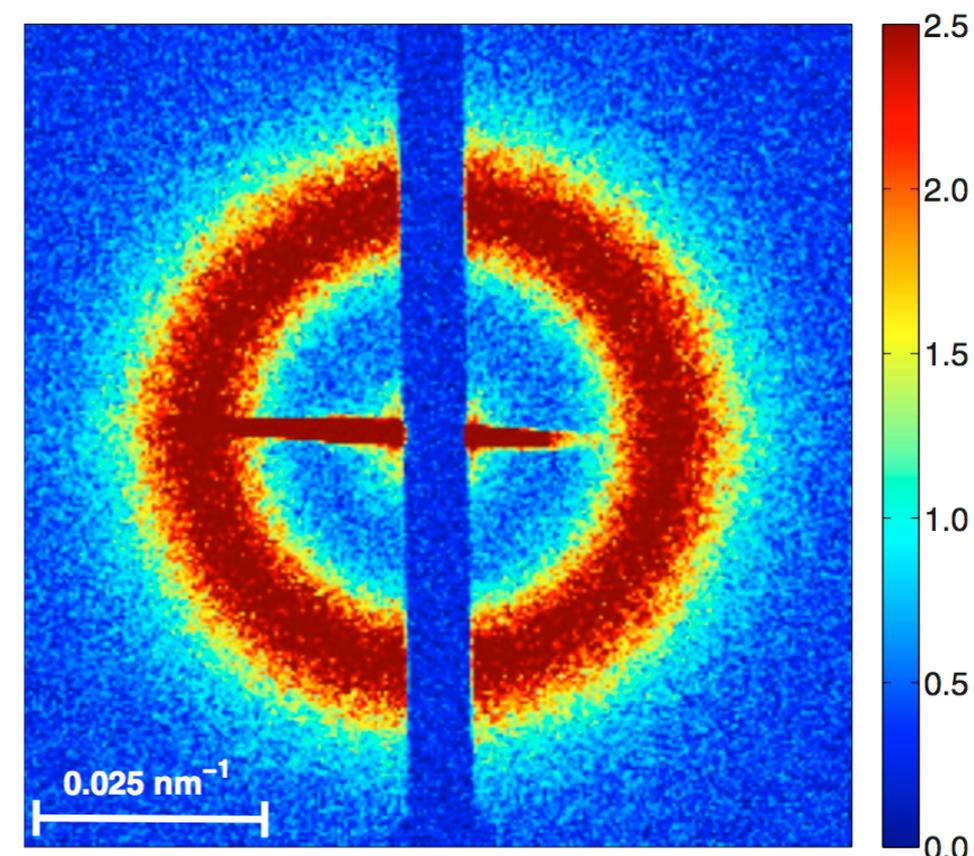


# Single-pulse magnetic scattering by EUV-FEL

実験配置 (FLASH@DESY, ドイツ)

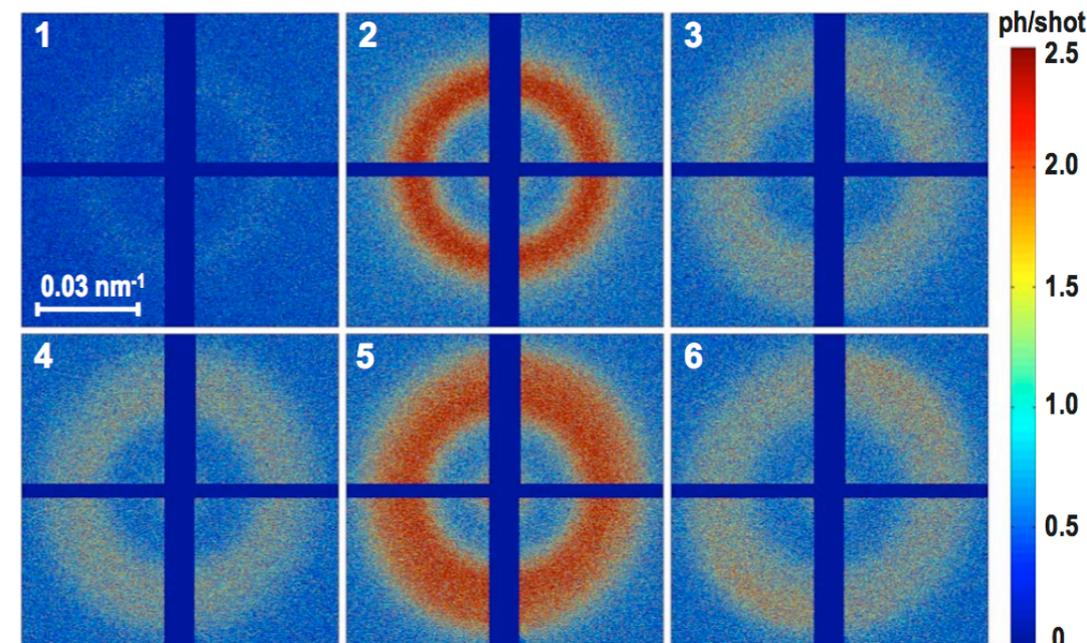


ワンショットFELパルスによる磁気散乱パターン



Co M<sub>2,3</sub> edge ( $h\nu = 59$  eV,  $\lambda = 20.8$  nm)

パルス幅 30 fs,  $2 \times 10^{11}$  photons/pulse



# まとめ

- **硬X線レンズレスホログラフィー法を開発**

- **散乱体を参照光源に用いる方法が有効**

Wドット:電子ビームアシスト-CVD法で形成

- **厚さ44 nm のCo/Pt磁性膜の電荷イメージング**

空間分解能 40 nm

- **磁気ホログラフィーイメージング**

→S/N比のさらなる改善へ

- **XFELへの展開**

回折磁気スペックル法

ps～fs領域での磁気ダイナミクスの観察